TLV915x-Q1 4.5Mhz、轨到轨输入或输出、低失调电压、低噪声汽车级运算放大器

1 特性

- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
  - 温度等级 1：–40°C 至 +125°C，T_A
  - 器件 HBM ESD 分类等级 3A
  - 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 低失调电压：±125μV
- 低失调电压漂移：±0.3μV/°C
- 低噪声：1kHz 时为 10.8nV/√Hz
- 高共模抑制：120dB
- 低偏置电流：±10pA
- 轨至轨输入和输出
- 高带宽：4.5MHz GBW
- 高压摆率：21V/μs
- 低静态电流：每个放大器 560μA
- 宽电源电压：±1.35V 至 ±8V，2.7V 至 16V
- 强大的 EMIRR 性能：输入引脚上采用 EMI/RFI 滤波器

2 应用

- 针对 AEC-Q100 1 级应用进行了优化
- 信息娱乐系统与仪表组
- 被动安全
- 车身电子装置和照明
- HEV/EV 逆变器和电机控制
- 车载充电器 (OBC) 和无线充电器
- 动力总成™电流传感器
- 高级驾驶辅助系统 (ADAS)
- 高侧和低侧电流检测

3 说明

TLV915x-Q1 系列（TLV9151-Q1、TLV9152-Q1 和 TLV9154-Q1）是 16V 通用汽车级运算放大器系列。这些器件具有出色的直流精度和交流性能，包括轨到轨输出、低失调电压（典型值为 ±125μV）、低温漂（典型值为 ±0.3μV/°C）和 4.5MHz 带宽。

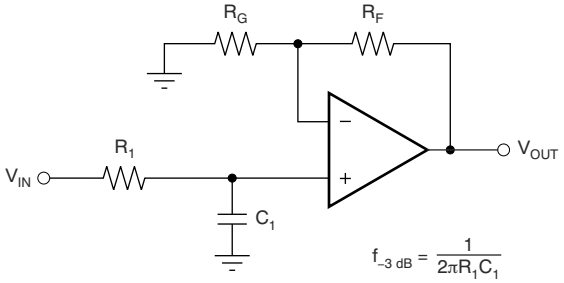
宽差分输入电压范围、高输出电流 (±75mA)、高压摆率 (21V/μs) 以及低噪声 (10.8nV/√Hz) 等便利功能使 TLV915x-Q1a 成为适用于汽车应用的强大低噪声运算放大器。

TLV915x-Q1 系列运算放大器采用标准封装，额定工作温度范围为 -40°C 至 125°C。

封装信息

器件型号	通道数	封装(1)	封装尺寸(2)
TLV9151-Q1	单通道	DBV（SOT-23，5）	2.9mm × 2.8mm
		DCK（SC70，5）	2mm x 2.1mm
	单通道，关断	DBV（SOT-23，6）	2.9mm × 2.8mm
TLV9152-Q1	双通道	D（SOIC，8）	4.9mm × 6mm
		PW（TSSOP，8）	3mm × 6.4mm
		DGK（VSSOP，8）	3mm × 4.9mm
TLV9154-Q1	四通道	D（SOIC，14）	8.65mm × 6mm
		DYY（SOT-23，14）	4.2mm × 3.26mm
		PW（TSSOP，14）	5mm × 6.4mm

(1) 如需了解所有可用封装，请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
(2) 封装尺寸（长 × 宽）为标称值，并包括引脚（如适用）。



$$\frac{V_{OUT}}{V_{IN}} = \left(1 + \frac{R_F}{R_G}\right)\left(\frac{1}{1 + sR_1C_1}\right)$$

TLV915x-Q1 应用于单极低通滤波器

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见，TI 提供了译文；由于翻译过程中可能使用了自动化工具，TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性，请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本（控制文档）。

内容

1 特性 1
2 应用 1
3 说明 1
4 引脚配置和功能 3
5 规格 7
5.1 绝对最大额定值 7
5.2 ESD 等级 7
5.3 建议运行条件 7
5.4 单通道器件的热性能信息 8
5.5 双通道器件的热性能信息 8
5.6 四通道器件的热性能信息 8
5.7 电气特性 8
5.8 典型特性 12
6 详细说明 19
6.1 概述 19
6.2 功能方框图 19
6.3 特性说明 19
6.4 器件功能模式 25
7 应用和实施 26
7.1 应用信息 26
7.2 典型应用 26
7.3 电源相关建议 27
7.4 布局 27
8 器件和文档支持 29
8.1 器件支持 29
8.2 文档支持 29
8.3 接收文档更新通知 29
8.4 支持资源 29
8.5 商标 30
8.6 静电放电警告 30
8.7 术语表 30
9 修订历史记录 30
10 机械、封装和可订购信息 30

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

4 引脚配置和功能

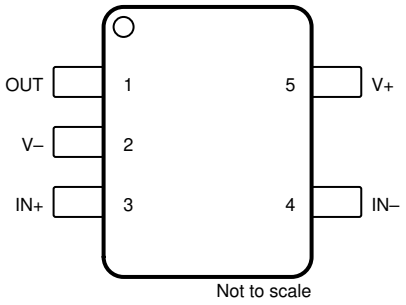


图 4-1. TLV9151-Q1 DBV 封装，5 引脚 SOT-23（顶视图）

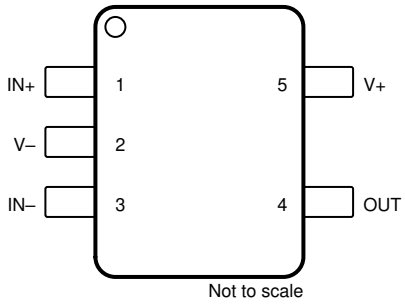


图 4-2. TLV9151-Q1 DCK 封装，5 引脚 SC70（顶视图）

表 4-1. 引脚功能：TLV9151-Q1

引脚			类型(1)	说明
名称	DBV	DCK		
IN+	3	1	I	同相输入
IN –	4	3	I	反相输入
OUT	1	4	O	输出
V+	5	5	—	正（最高）电源
V –	2	2	—	负（最低）电源

(1) I = 输入，O = 输出

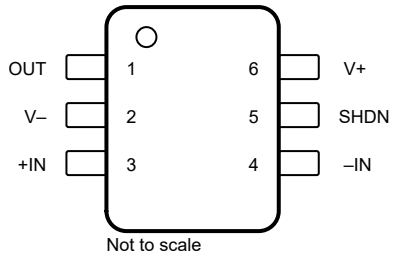


图 4-3. TLV9151S-Q1 DBV 封装，6 引脚 SOT-23（顶视图）

表 4-2. 引脚功能：TLV9151S-Q1

引脚		类型(1)	说明
名称	编号		
IN+	3	I	同相输入
IN –	4	I	反相输入
OUT	1	O	输出
SHDN	5	I	关断：低电平 = 放大器被启用；高电平 = 放大器被禁用。有关更多信息，请参阅节 6.3.9。
V+	6	—	正（最高）电源

表 4-2. 引脚功能：TLV9151S-Q1（续）

引脚		类型(1)	说明
名称	编号		
V–	2	—	负（最低）电源

(1) I = 输入，O = 输出

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

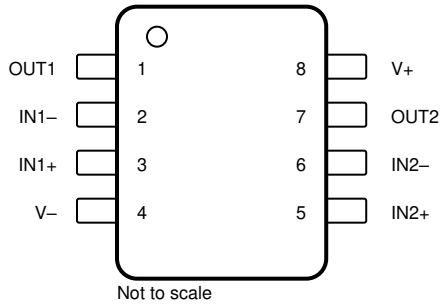


图 4-4. TLV9152-Q1D、PW 和 DGK 封装，8 引脚 SOIC、TSSOP 和 VSSOP（顶视图）

表 4-3. 引脚功能：TLV9152-Q1

引脚		类型(1)	说明
名称	编号		
IN1+	3	I	同相输入，通道 1
IN2+	5	I	同相输入，通道 2
IN1–	2	I	反相输入，通道 1
IN2–	6	I	反相输入，通道 2
OUT1	1	O	输出，通道 1
OUT2	7	O	输出，通道 2
V+	8	—	正（最高）电源
V–	4	—	负（最低）电源

(1) I = 输入，O = 输出

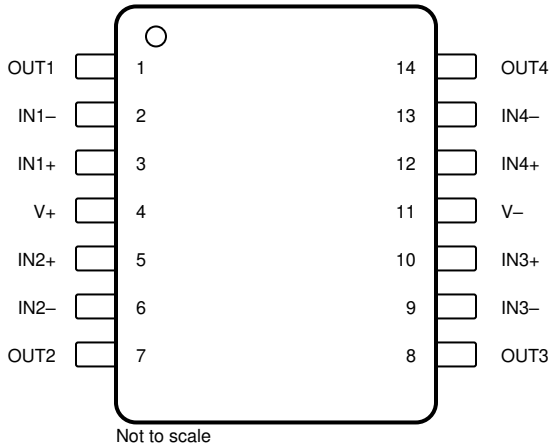


图 4-5. TLV9154-Q1D、DYY 和 PW 封装，14 引脚 SOIC、SOT-23 和 TSSOP（顶视图）

表 4-4. 引脚功能：TLV9154-Q1

引脚		类型(1)	说明
名称	编号		
IN1+	3	I	同相输入，通道 1
IN1–	2	I	反相输入，通道 1

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

表 4-4. 引脚功能：TLV9154-Q1（续）

引脚		类型(1)	说明
名称	编号		
IN2+	5	I	同相输入，通道 2
IN2–	6	I	反相输入，通道 2
IN3+	10	I	同相输入，通道 3
IN3–	9	I	反相输入，通道 3
IN4+	12	I	同相输入，通道 4
IN4–	13	I	反相输入，通道 4
OUT1	1	O	输出，通道 1
OUT2	7	O	输出，通道 2
OUT3	8	O	输出，通道 3
OUT4	14	O	输出，通道 4
V+	4	—	正（最高）电源
V–	11	—	负（最低）电源

(1) I = 输入，O = 输出

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

5 规格

5.1 绝对最大额定值

在工作环境温度范围内测得（除非另有说明）(1)

		最小值	最大值	单位
电源电压，V_S = (V+) – (V–)		0	20	V
信号输入引脚	共模电压(3)	(V–) – 0.5	(V+) + 0.5	V
	差分电压(3)		V_S + 0.2	V
	电流(3)	-10	10	mA
输出短路(2)		持续		
工作环境温度，T_A		-55	150	°C
结温，T_J			150	°C
存储温度，T_{stg}		-65	150	°C

(1) 超出*绝对最大额定值*运行可能会对器件造成永久损坏。*绝对最大额定值*并不表示器件在这些条件下或在*建议运行条件*以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出*建议运行条件*但在*绝对最大额定值*范围内使用，器件可能不会完全正常运行，这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。
(2) 接地短路，每个封装对应一个放大器。
(3) 输入引脚被二极管钳制至电源轨。对于摆幅超过电源轨 0.5V 以上的输入信号，其电流必须限制在 10mA 或者更低。

5.2 ESD 等级

			值	单位
$V_{(ESD)}$	静电放电	人体放电模型 (HBM)，符合 AEC Q100-002 标准(1)	±2000	V
		仅 TLV9151SQDBVRQ1：人体放电模型 (HBM)，符合 AEC Q100-002 标准(1)	±1000	
		充电器件模型 (CDM)，符合 AEC Q100-011 标准	±1000	

(1) AEC Q100-002 指示应当按照 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 规范执行 HBM 应力测试。

5.3 建议运行条件

在工作环境温度范围内测得（除非另有说明）

		最小值	最大值	单位
V_S	电源电压，(V+) – (V–)	2.7	16	V
V_I	输入电压范围	(V–) – 0.1	(V+) + 0.1	V
V_{IH}	关断引脚上的高电平输入电压（放大器为启用状态）	1.1	(V+)	V
V_{IL}	关断引脚上的低电平输入电压（放大器为禁用状态）	(V–)	0.2	V
T_A	额定环境温度	-40	125	°C

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

5.4 单通道器件的热性能信息

热指标 (1)		TLV9151-Q1、TLV9151S-Q1			单位
		DBV (SOT-23)		DCK (SC70)	
		5 引脚	6 引脚	5 引脚	
$R_{\theta JA}$	结至环境热阻	187.4	167.8	202.6	°C/W
$R_{\theta JC(top)}$	结至外壳（顶部）热阻	86.2	107.9	101.5	°C/W
$R_{\theta JB}$	结至电路板热阻	54.6	49.7	47.8	°C/W
ψ_{JT}	结至顶部特征参数	27.8	33.9	18.8	°C/W
ψ_{JB}	结至电路板特征参数	54.3	49.5	47.4	°C/W
$R_{\theta JC(bot)}$	结至外壳（底部）热阻	不适用	不适用	不适用	°C/W

(1) 有关新旧热指标的更多信息，请参阅*半导体和 IC 封装热指标*应用手册。

5.5 双通道器件的热性能信息

热指标 (1)		TLV9152-Q1			单位
		D (SOIC)	DGK (VSSOP)	PW (TSSOP)	
		8 引脚	8 引脚	8 引脚	
$R_{\theta JA}$	结至环境热阻	132.6	176.5	185.1	°C/W
$R_{\theta JC(top)}$	结至外壳（顶部）热阻	73.4	68.1	74.0	°C/W
$R_{\theta JB}$	结至电路板热阻	76.1	98.2	115.7	°C/W
ψ_{JT}	结至顶部特征参数	24.0	12.0	12.3	°C/W
ψ_{JB}	结至电路板特征参数	75.4	96.7	114.0	°C/W
$R_{\theta JC(bot)}$	结至外壳（底部）热阻	不适用	不适用	不适用	°C/W

(1) 有关新旧热指标的更多信息，请参阅*半导体和 IC 封装热指标*应用手册。

5.6 四通道器件的热性能信息

热指标 (1)		TLV9154-Q1			单位
		D (SOIC)	DYY (SOT-23)	PW (TSSOP)	
		14 引脚	14 引脚	14 引脚	
$R_{\theta JA}$	结至环境热阻	101.4	110.7	118.0	°C/W
$R_{\theta JC(top)}$	结至外壳（顶部）热阻	57.6	55.9	47.6	°C/W
$R_{\theta JB}$	结至电路板热阻	57.3	35.3	60.9	°C/W
ψ_{JT}	结至顶部特征参数	18.5	2.3	6.0	°C/W
ψ_{JB}	结至电路板特征参数	56.9	35.1	60.4	°C/W
$R_{\theta JC(bot)}$	结至外壳（底部）热阻	不适用	不适用	不适用	°C/W

(1) 有关新旧热指标的更多信息，请参阅*半导体和 IC 封装热指标*应用手册。

5.7 电气特性

V_S = (V+) – (V–) = 2.7V 至 16V（±1.35V 至 ±8V），T_A = 25°C，R_L = 10kΩ（连接至 V_S/2），V_{CM} = V_S/2，且 V_{OUT} = V_S/2（除非另有说明）。

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
失调电压					

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

5.7 电气特性（续）

V_S = (V+) – (V–) = 2.7V 至 16V（±1.35V 至 ±8V），T_A = 25°C，R_L = 10kΩ（连接至 V_S/2），V_{CM} = V_S/2，且 V_{OUT} = V_S/2（除非另有说明）。

参数		测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
V_{OS}	输入偏移电压	V_{CM} = V–			±125	±895	μV
			T_A = -40°C 至 125°C			±925	
dV_{OS}/dT	输入失调电压漂移		T_A = -40°C 至 125°C		±0.3		μV/°C
PSRR	输入失调电压与电源间的关系	V_{CM} = V–，V_S = 4V 至 16V	T_A = -40°C 至 125°C		±0.3	±1.5	μV/V
		V_{CM} = V–，V_S = 2.7V 至 16 V(4)			±1	±10.6	
	通道隔离	f = 0Hz			5		μV/V
输入偏置电流							
I_B	输入偏置电流				±10		pA
			T_A = -40°C 至 125°C(4)			±1	nA
I_{OS}	输入偏移电流				±10		pA
			T_A = -40°C 至 125°C(4)			±1	nA
噪声							
E_N	输入电压噪声	f = 0.1Hz 至 10Hz			1.8		μV_{PP}
					0.3		μV_{RMS}
e_N	输入电压噪声密度	f = 1kHz			10.8		nV/√Hz
		f = 10kHz			9.4		
i_N	输入电流噪声	f = 1kHz			2		fA/√Hz
输入电压范围							
V_{CM}	共模电压范围			(V–) – 0.1		(V+) + 0.1	V
CMRR	共模抑制比	V_S = 16V，(V–) – 0.1V < V_{CM} < (V+) – 2V（主输入对）	T_A = -40°C 至 125°C	99	130		dB
		V_S = 4V，(V–) – 0.1V < V_{CM} < (V+) – 2V（主输入对）		82	100		
		V_S = 2.7V，(V–) – 0.1V < V_{CM} < (V+) – 2V（主输入对）(4)		75	95		
		V_S = 2.7V 至 16 V，(V+) – 1V < V_{CM} < (V+) + 0.1V（辅助输入对）			85		
输入电容							
Z_{ID}	差分				100 || 9		MΩ || pF
Z_{ICM}	共模				6 || 1		TΩ || pF
开环增益							
A_{OL}	开环电压增益	V_S = 16V，V_{CM} = V– (V–) + 0.1V < V_O < (V+) – 0.1V		120	145		dB
			T_A = -40°C 至 125°C		142		
		V_S = 4V，V_{CM} = V– (V–) + 0.1V < V_O < (V+) – 0.1V		104	130		
			T_A = -40°C 至 125°C		125		
		V_S = 2.7V，V_{CM} = V–，(V–) + 0.1V < V_O < (V+) – 0.1V(4)		101	120		
			T_A = -40°C 至 125°C		118		

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

5.7 电气特性（续）

V_S = (V+) – (V–) = 2.7V 至 16V（±1.35V 至 ±8V），T_A = 25°C，R_L = 10kΩ（连接至 V_S/2），V_{CM} = V_S/2，且 V_{OUT} = V_S/2（除非另有说明）。

参数		测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
频率响应							
GBW	增益带宽积				4.5		MHz
SR	压摆率	V_S = 16V，G = +1，C_L = 20pF			21		V/μs
t_S	趋稳时间	精度达到 0.01%，V_S = 16V，V_{STEP} = 10V，G = +1，CL = 20pF			2.5		μs
		精度达到 0.01%，V_S = 16V，V_{STEP} = 2V，G = +1，CL = 20pF			1.5		
		精度达到 0.1%，V_S = 16V，V_{STEP} = 10V，G = +1，CL = 20pF			2		
		精度达到 0.1%，V_S = 16V，V_{STEP} = 2V，G = +1，CL = 20pF			1		
	相位裕度	G = +1，R_F = 10kΩ			60		°
	过载恢复时间	V_{IN} × 增益 > V_S			400		ns
THD+N	总谐波失真 + 噪声 (1)	V_S = 16V，V_O = 3V_{RMS}，G = 1，f = 1kHz			0.00021%		
输出							
	相对于电源轨的电压输出摆幅（正和负）	V_S = 16V，R_L = 空载			5	10	mV
			T_A = -40°C 至 125°C (4)			15	
		V_S = 16V，R_L = 10kΩ			50	55	
			T_A = -40°C 至 125°C (4)			75	
		V_S = 16V，R_L = 2kΩ			200	250	
			T_A = -40°C 至 125°C (4)			350	
		V_S = 2.7V，R_L = 空载			1	6	
			T_A = -40°C 至 125°C (4)			10	
		V_S = 2.7V，R_L = 10kΩ			5	12	
			T_A = -40°C 至 125°C (4)			18	
		V_S = 2.7V，R_L = 2kΩ			25	40	
			T_A = -40°C 至 125°C (4)			60	
I_{SC}	短路电流				±75		mA
C_{LOAD}	容性负载驱动				1000		pF
Z_O	开环输出阻抗	f = 1MHz，I_O = 0A			525		Ω
电源							
I_Q	每个放大器的静态电流	I_O = 0A			560	685	μA
		I_O = 0A，(TLV9151-Q1)			560	691	
		I_O = 0A	T_A = -40°C 至 125°C			750	
		I_O = 0A，(TLV9151-Q1)				769	
关断							
I_{QSD}	每个放大器的静态电流	V_S = 2.7V 至 16V，所有放大器均为禁用状态，$\overline{SHDN}$ = V–			30	45	μA
Z_{SHDN}	关断时的输出阻抗	V_S = 2.7V 至 16V，放大器被禁用			320 || 2		MΩ || pF

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

5.7 电气特性（续）

V_S = (V+) – (V–) = 2.7V 至 16V（±1.35V 至 ±8V），T_A = 25°C，R_L = 10kΩ（连接至 V_S/2），V_{CM} = V_S/2，且 V_{OUT} = V_S/2（除非另有说明）。

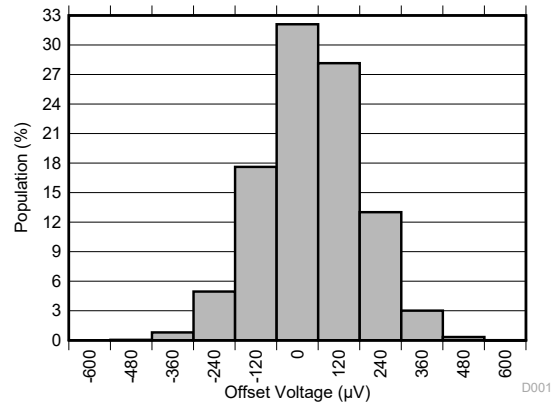
参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{IH}	逻辑高电平阈值电压（放大器被禁用）			(V–) + 0.8V	(V–) + 1.1V	V
V_{IL}	逻辑低电平阈值电压（放大器被启用）		(V–) + 0.2V	(V–) + 0.8V		V
t_{ON}	放大器启用时间（完全关断）(2) (3)	G = +1，V_{CM} = V-，V_O = 0.1 × V_S/2		8		μs
t_{ON}	放大器启用时间（部分关断）(2) (3)	G = +1，V_{CM} = V-，V_O = 0.1 × V_S/2		3		μs
t_{OFF}	放大器禁用时间(2)	V_{CM} = V-，V_O = V_S/2		3		μs
	$\overline{SHDN}$ 引脚输入偏置电流（每个引脚）	V_S = 2.7V 至 16V，(V+) ≥ $\overline{SHDN}$ ≥ (V–) + 0.9V		500		nA
		V_S = 2.7V 至 16V，(V–) ≤ $\overline{SHDN}$ ≤ (V–) + 0.7V		150		nA

(1) 三阶滤波器；-3dB 时的带宽 = 80kHz。
(2) 禁用时间 (t_{OFF}) 和启用时间 (t_{ON}) 是指施加给 $\overline{SHDN}$ 引脚的信号为 50% 时到输出电压达到 10%（禁用）或 90%（启用）电平时之间的间隔。
(3) 完全关断是指双通道 TLVxx2S 的通道 1 和 2 都被禁用 ($\overline{SHDN1}$ = $\overline{SHDN2}$ = V–) 且四路 TLV9xx4S 的通道 1 至 4 都被禁用 ($\overline{SHDN12}$ = $\overline{SHDN34}$ = V–)。对于部分关断，仅使用 $\overline{SHDN}$ 引脚；在这种模式下，内部偏置电路仍然保持正常工作，并且启用时间更短。
(4) 仅由特性确定。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

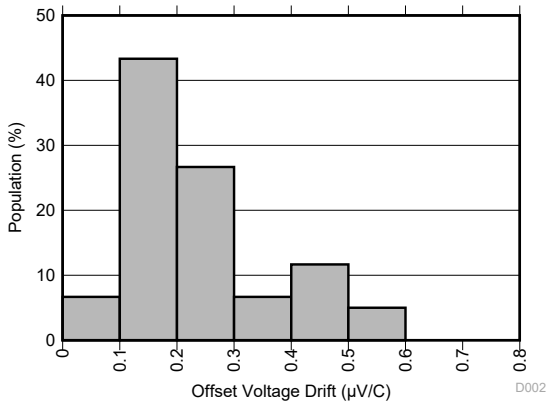
5.8 典型特性

T_A = 25°C，V_S = ±8V，V_{CM} = V_S / 2，R_{LOAD} = 10kΩ 连接至 V_S / 2，且 C_L = 10pF（除非另有说明）



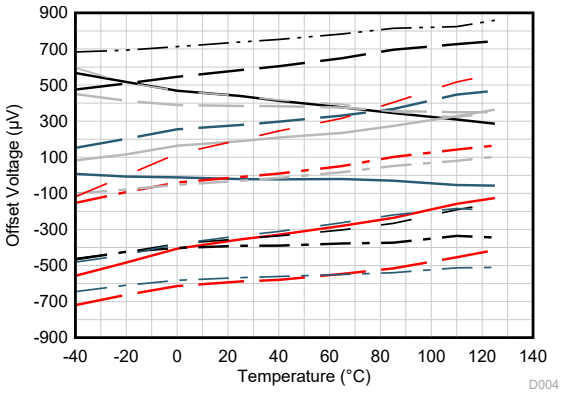
T_A = 25°C 时 15462 个放大器的分配

图 5-1. 失调电压产生分布



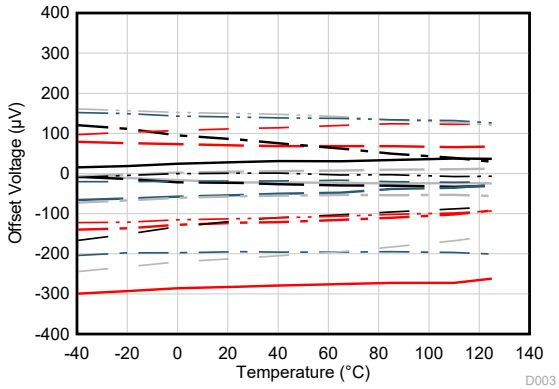
60 个放大器的分配

图 5-2. 失调电压漂移分配



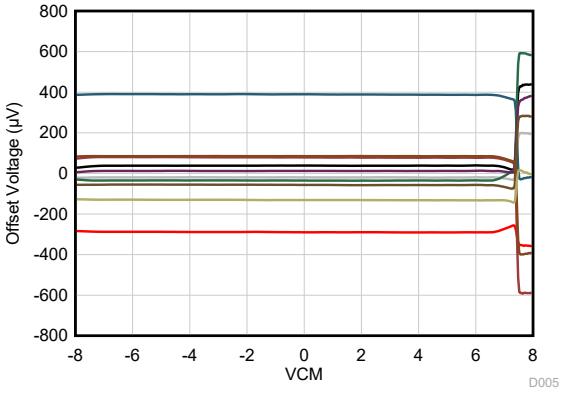
V_{CM} = V+

图 5-3. 失调电压与温度间的关系



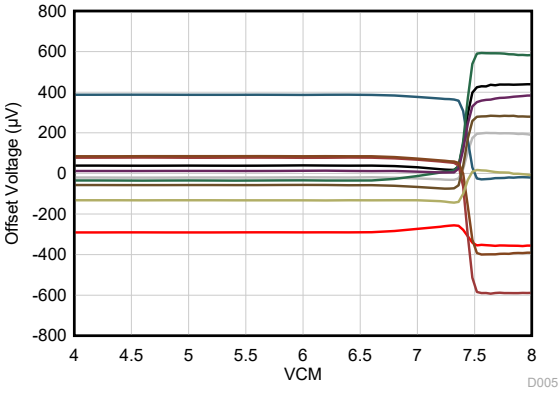
V_{CM} = V –

图 5-4. 失调电压与温度间的关系



T_A = 25°C

图 5-5. 失调电压与共模电压间的关系



T_A = 25°C

图 5-6. 失调电压与共模电压间的关系（切换区域）

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

5.8 典型特性 (续)

T_A = 25°C，V_S = ±8V，V_{CM} = V_S / 2，R_{LOAD} = 10kΩ 连接至 V_S / 2，且 C_L = 10pF（除非另有说明）

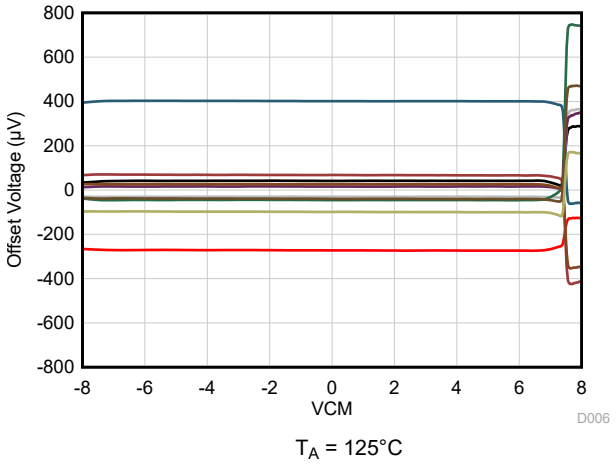


图 5-7. 失调电压与共模电压间的关系

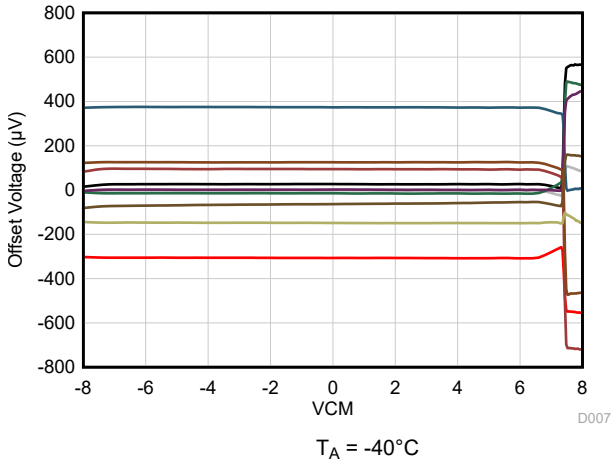


图 5-8. 失调电压与共模电压间的关系

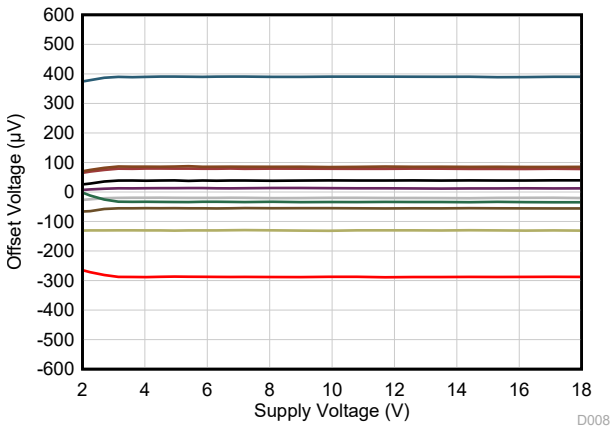


图 5-9. 失调电压与电源间的关系

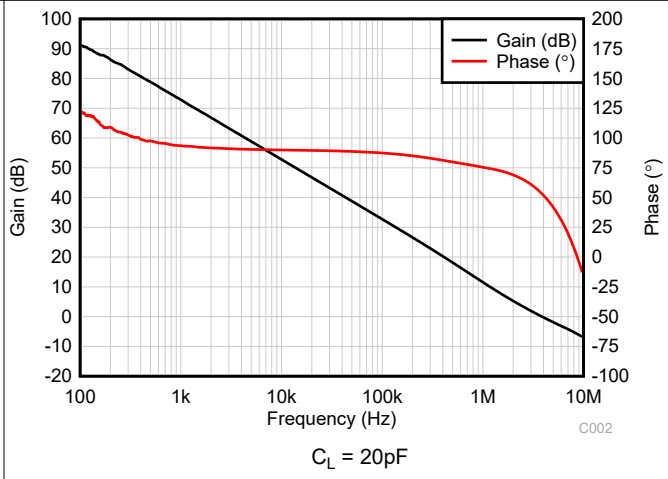


图 5-10. 开环增益和相位与频率间的关系

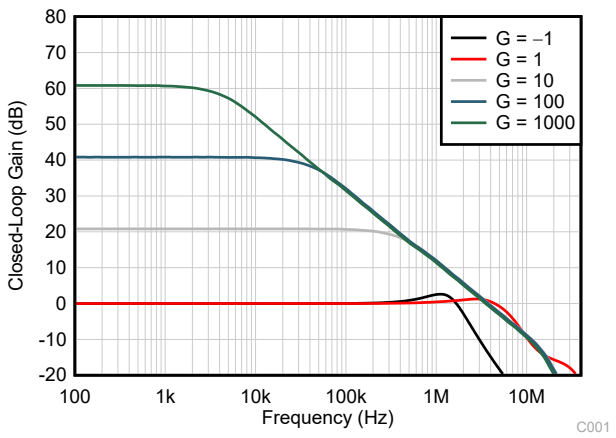


图 5-11. 闭环增益与频率间的关系

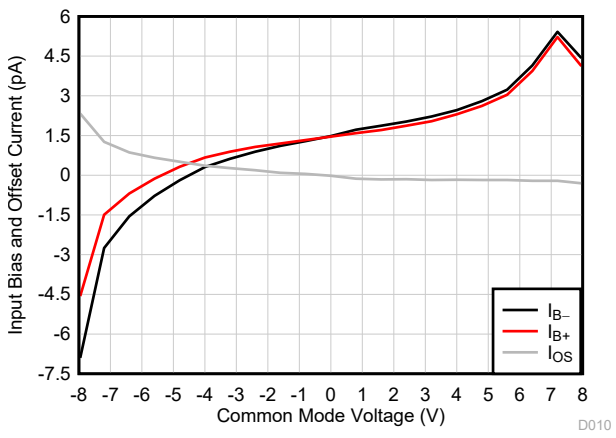


图 5-12. 输入偏置电流与共模电压间的关系

5.8 典型特性 (续)

T_A = 25°C，V_S = ±8V，V_{CM} = V_S / 2，R_{LOAD} = 10kΩ 连接至 V_S / 2，且 C_L = 10pF（除非另有说明）

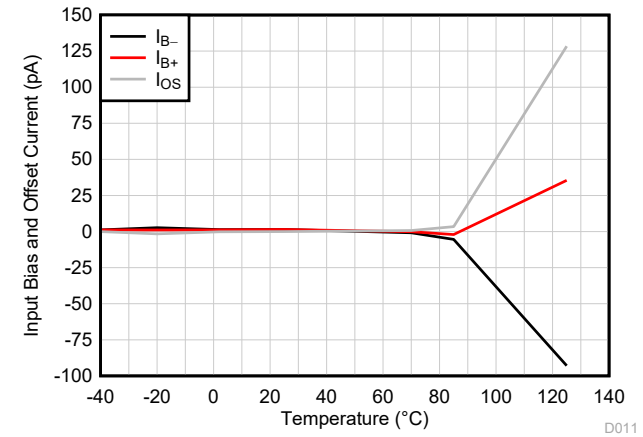


图 5-13. 输入偏置电流与温度间的关系

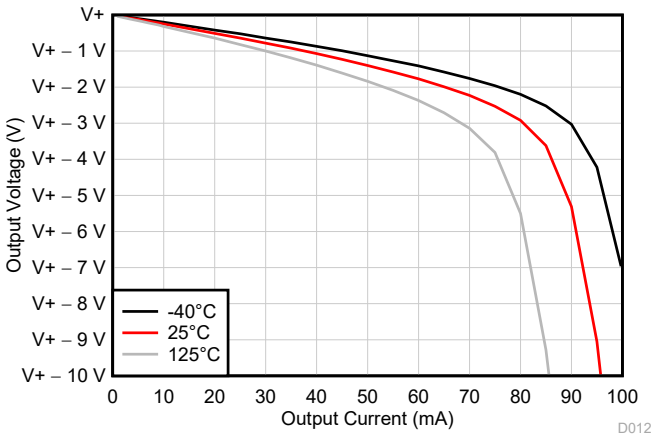


图 5-14. 输出电压摆幅与输出电流（拉电流）间的关系

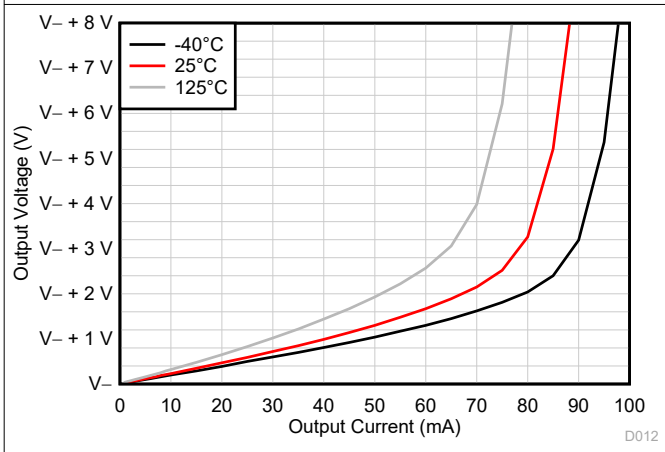


图 5-15. 输出电压摆幅与输出电流（灌电流）间的关系

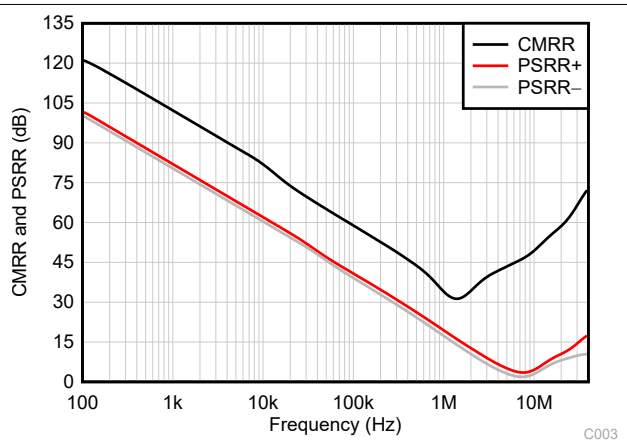


图 5-16. CMRR 和 PSRR 与频率间的关系

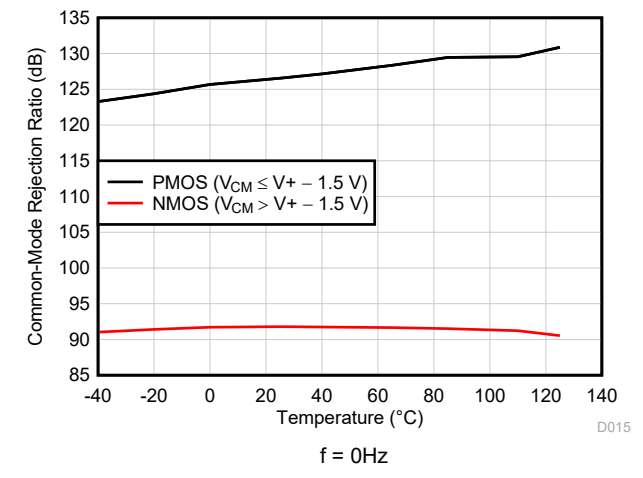


图 5-17. CMRR 与温度间的关系 (dB)

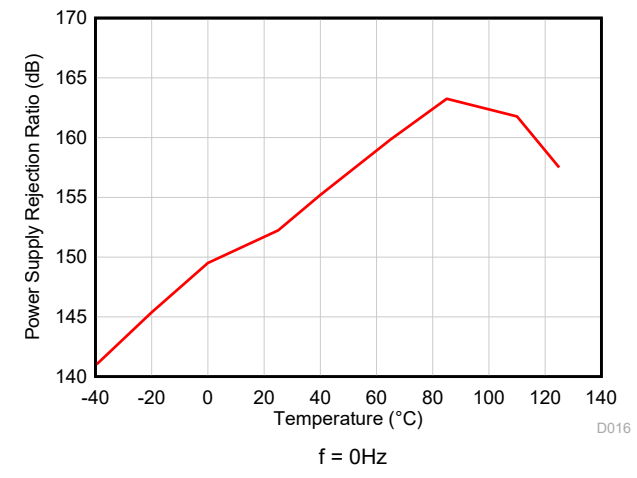


图 5-18. PSRR 与温度间的关系 (dB)

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

5.8 典型特性 (续)

T_A = 25°C，V_S = ±8V，V_{CM} = V_S / 2，R_{LOAD} = 10kΩ 连接至 V_S / 2，且 C_L = 10pF（除非另有说明）

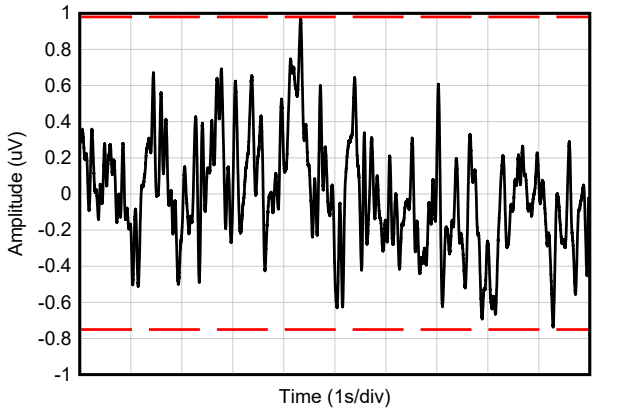


图 5-19. 0.1Hz 至 10Hz 噪声

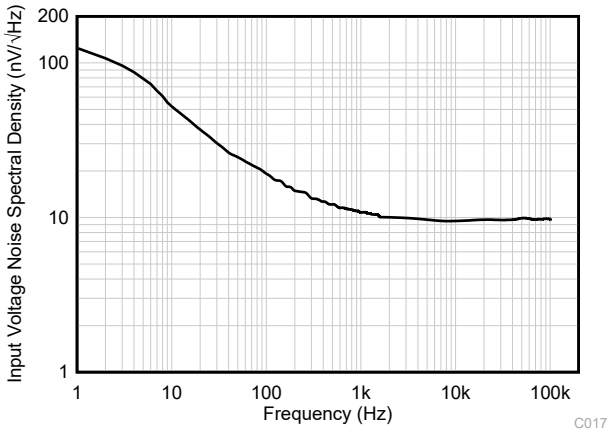
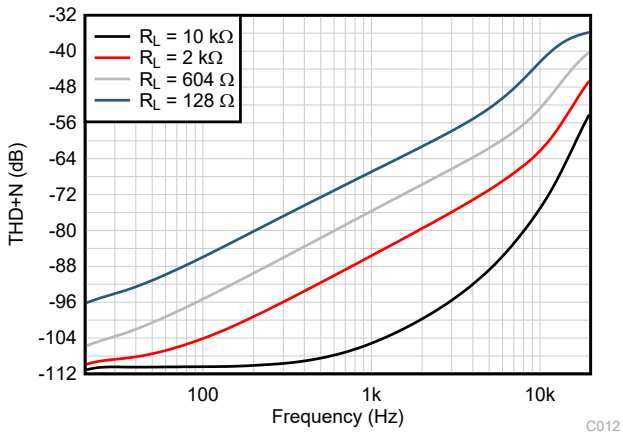
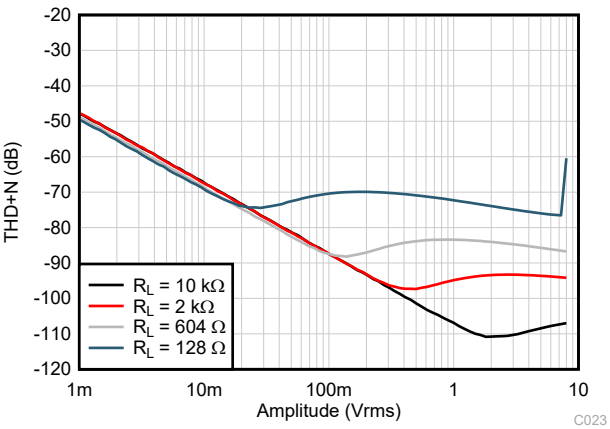


图 5-20. 输入电压噪声频谱密度与频率间的关系



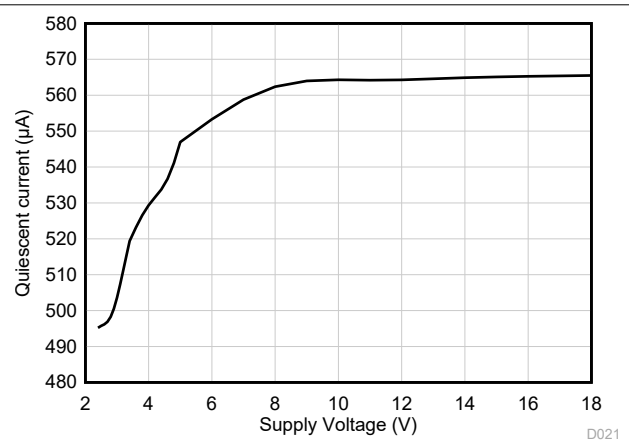
BW = 80kHz，V_{OUT} = 1V_{RMS}

图 5-21. THD+N 比与频率间的关系



BW = 80kHz，f = 1kHz

图 5-22. THD+N 与输出幅度间的关系



V_{CM} = V –

图 5-23. 静态电流与电源电压间的关系

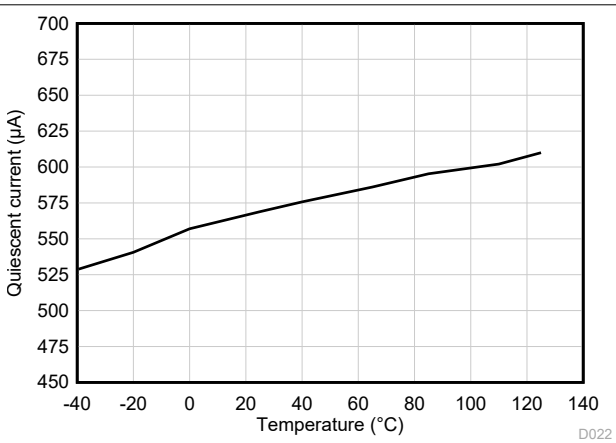


图 5-24. 静态电流与温度间的关系

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

5.8 典型特性 (续)

T_A = 25°C，V_S = ±8V，V_{CM} = V_S / 2，R_{LOAD} = 10kΩ 连接至 V_S / 2，且 C_L = 10pF（除非另有说明）

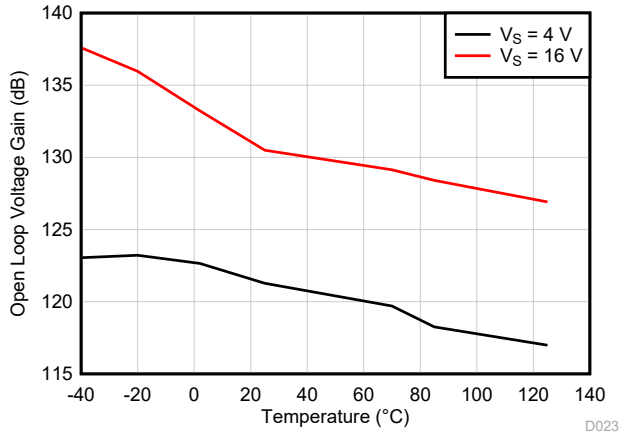


图 5-25. 开环电压增益与温度间的关系 (dB)

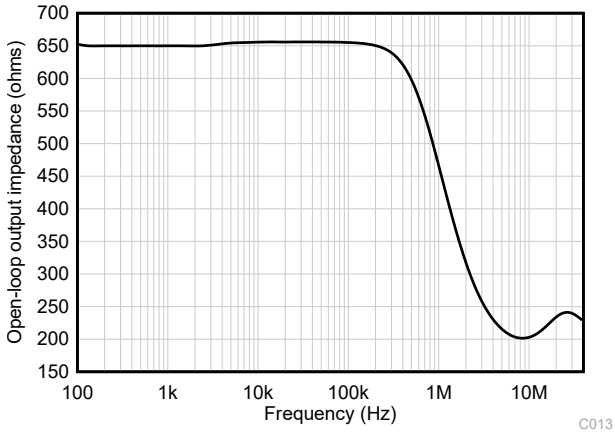
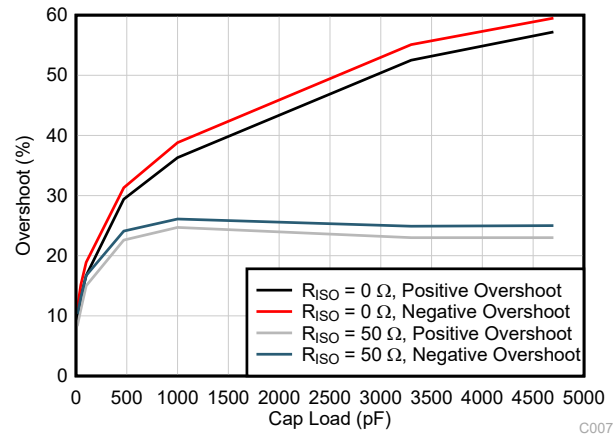
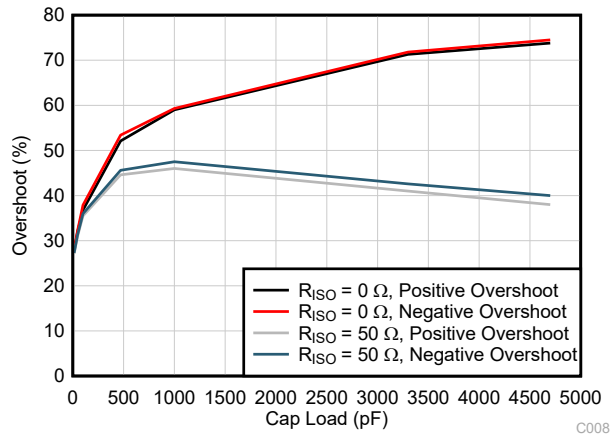


图 5-26. 开环输出阻抗与频率间的关系



G = –1，10mV 输出阶跃

图 5-27. 小信号过冲与容性负载间的关系



G = 1，10mV 输出阶跃

图 5-28. 小信号过冲与容性负载间的关系

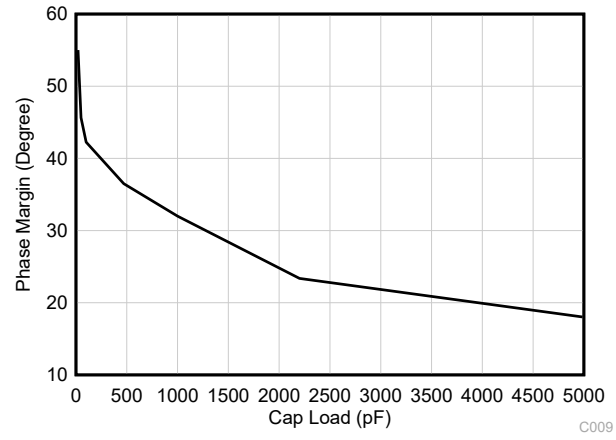
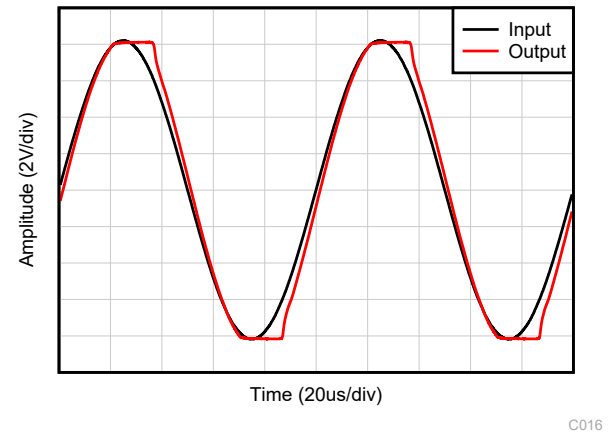


图 5-29. 相位裕度与容性负载间的关系



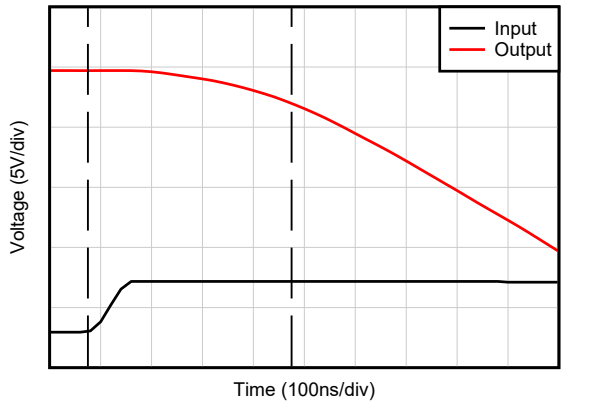
V_{IN} = ±8V；V_S = V_{OUT} = ±8V

图 5-30. 无相位反转

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

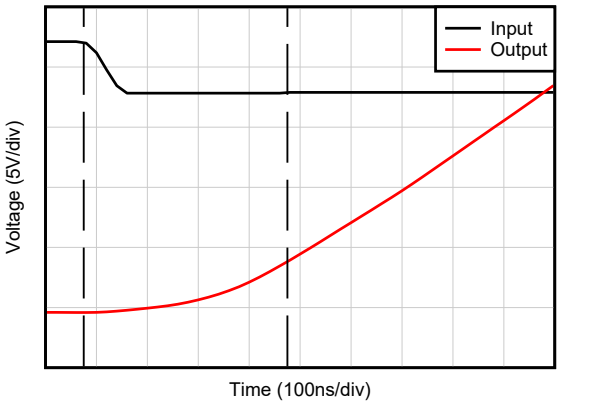
5.8 典型特性 (续)

T_A = 25°C，V_S = ±8V，V_{CM} = V_S / 2，R_{LOAD} = 10kΩ 连接至 V_S / 2，且 C_L = 10pF（除非另有说明）



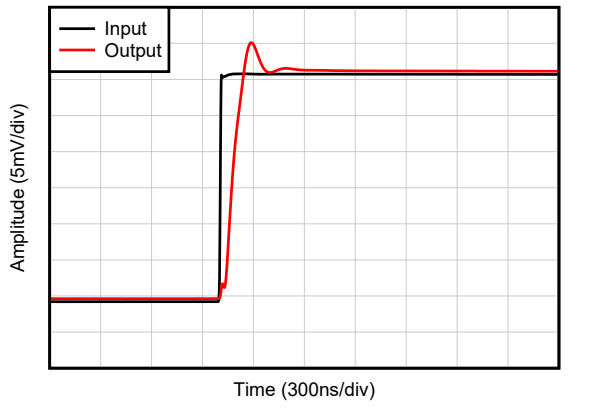
G = -10

图 5-31. 正过载恢复



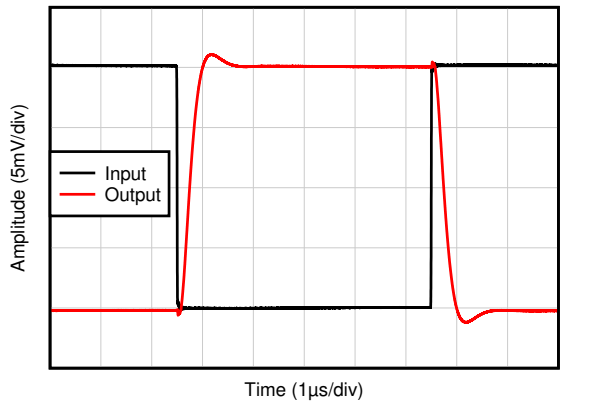
G = -10

图 5-32. 负过载恢复



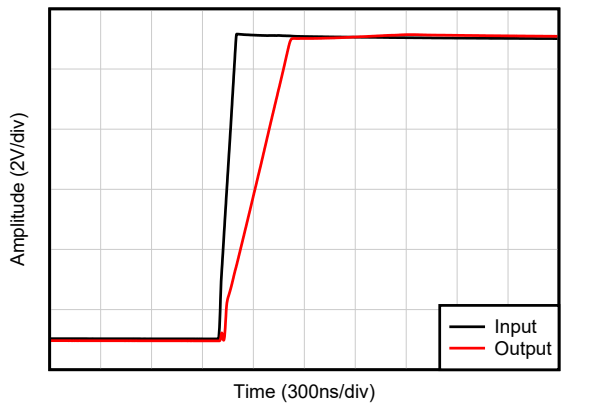
C_L = 20pF，G = 1，20mV 阶跃响应

图 5-33. 小信号阶跃响应，上升



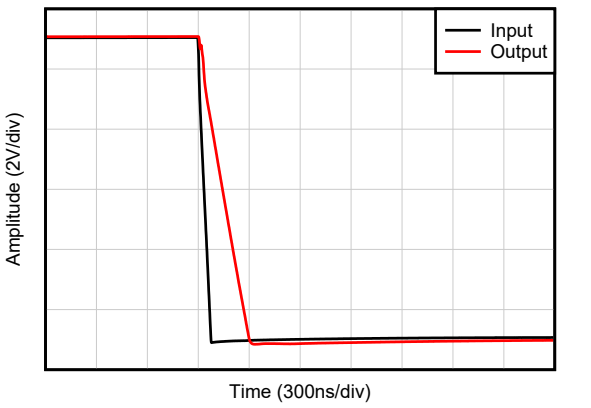
C_L = 20pF，G = -1，20mV 阶跃响应

图 5-34. 小信号阶跃响应



C_L = 20pF，G = 1

图 5-35. 大信号阶跃响应（上升）



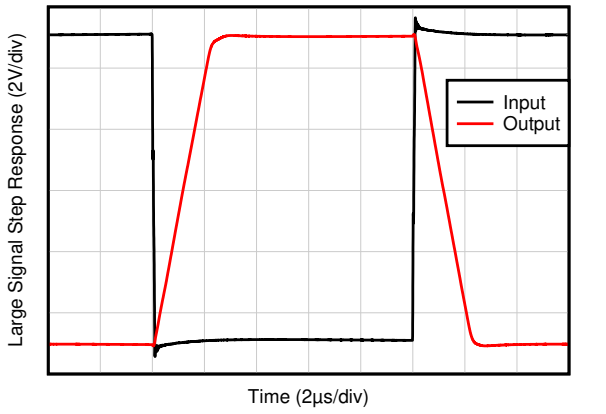
C_L = 20pF，G = 1

图 5-36. 大信号阶跃响应（下降）

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

5.8 典型特性 (续)

T_A = 25°C，V_S = ±8V，V_{CM} = V_S / 2，R_{LOAD} = 10kΩ 连接至 V_S / 2，且 C_L = 10pF（除非另有说明）



C_L = 20pF，G = -1

图 5-37. 大信号阶跃响应

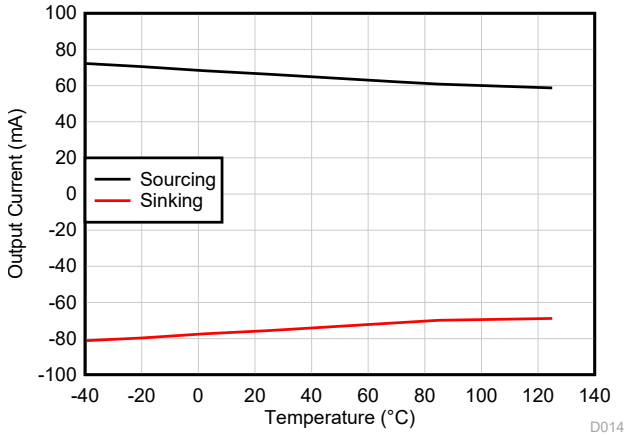


图 5-38. 短路电流与温度间的关系

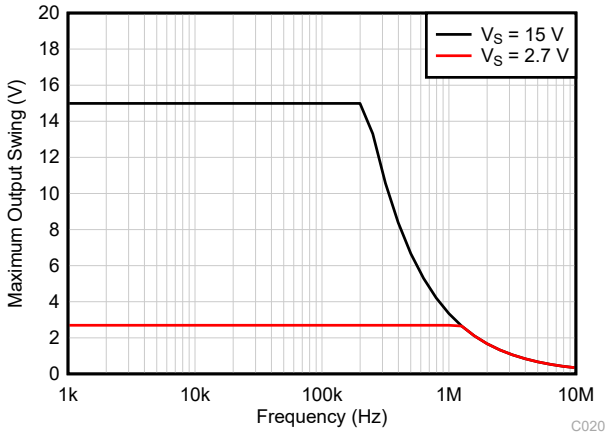


图 5-39. 最大输出电压与频率间的关系

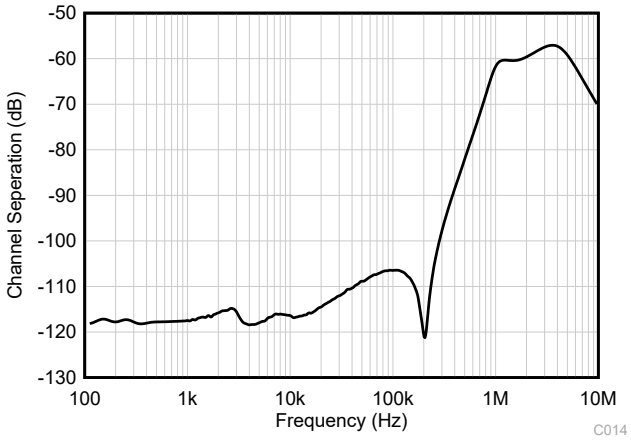


图 5-40. 通道隔离与频率间的关系

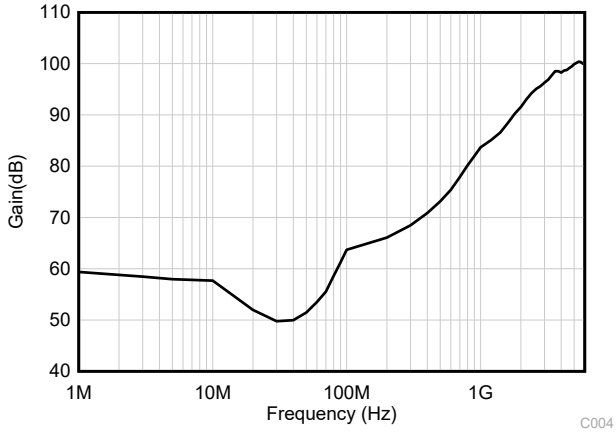


图 5-41. EMIRR（电磁干扰抑制比）输入与频率间的关系

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

6 详细说明

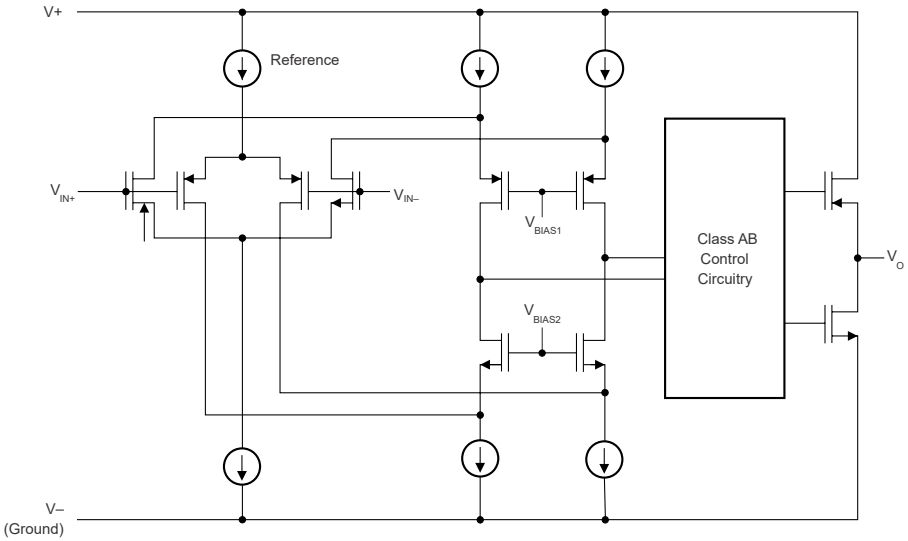
6.1 概述

TLV915x-Q1 系列（TLV9151-Q1、TLV9152-Q1 和 TLV9154-Q1）是 16V 通用运算放大器系列。

这些器件具有出色的直流精度和交流性能，包括轨到轨输入/输出、低失调电压（典型值为 ±125μV）、低温漂（典型值为 ±0.3μV/°C）和 4.5MHz 带宽。

宽差分和共模输入电压范围、高输出电流 (±75mA)、高压摆率 (21V/μs)、低功耗运行（560μA，典型值）和关断功能使 TLV915x-Q1a 成为适用于汽车应用的稳健、高速、高性能运算放大器。

6.2 功能方框图



6.3 特性说明

6.3.1 EMI 抑制

TLV915x-Q1 使用集成电磁干扰 (EMI) 滤波功能来降低干扰源（如无线通信设备以及混合使用模拟信号链和数字元件的高密度电路板）产生的 EMI 效应。利用电路设计技术提高 EMI 抗扰度；TLV915x-Q1 可从这些设计改进中受益。德州仪器 (TI) 已具备在 10MHz 至 6GHz 宽频谱范围内准确测量和量化运算放大器抗扰度的能力。图 6-1 展示了对 TLV915x-Q1 执行此测试的结果。表 6-1 提供了 TLV915x-Q1 在实际应用中通常会遇到的特定频率下的 EMIRR IN+ 值。*运算放大器的 EMI 抑制比* 应用手册包含了与运算放大器相关的 EMIRR 性能主题详细信息，该手册可从 www.ti.com 下载。

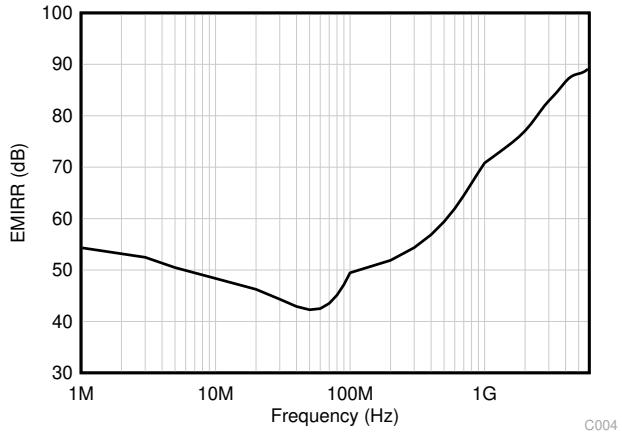


图 6-1. EMIRR 测试

表 6-1. TLV915x-Q1 在相关频率下的 EMIRR IN+

频率	应用或分配	EMIRR IN+
400MHz	移动无线广播、移动卫星、太空操作、气象、雷达、超高频 (UHF) 应用	59.5dB
900MHz	全球移动通信系统 (GSM) 应用、无线电通信、导航、GPS（最高可达 1.6GHz）、GSM、航空移动通信及 UHF 应用	68.9dB
1.8GHz	GSM 应用、个人移动通信、宽带、卫星和 L 波段（1GHz 至 2GHz）	77.8dB
2.4GHz	802.11b、802.11g、802.11n、Bluetooth®、个人移动通信、工业、科学和医疗 (ISM) 无线频段、业余无线电通信和卫星、S 波段（2GHz 至 4GHz）	78.0dB
3.6GHz	无线电定位、航空通信和导航、卫星、移动通信、S 波段	88.8dB
5GHz	802.11a、802.11n、航空通信和导航、移动通信、太空和卫星运行、C 波段（4GHz 至 8GHz）	87.6dB

6.3.2 过热保护

任何放大器的内部功耗都会导致内部温度（结温）升高。这一现象称为*自热*。TLV915x-Q1 的绝对最大结温为 150°C。超过此温度会损坏器件。TLV915x-Q1 具有过热保护功能，可减少自热造成的损坏。该保护功能的工作原理是监视器件的温度，并在温度超过 170°C 时关闭运算放大器输出驱动。图 6-2 展示了 TLV9151-Q1 的应用示例，该器件因为其功耗 (0.81W) 而会产生显著的自热。热计算表明，当环境温度为 65°C 时，器件结温达到 177°C。不过，实际器件会关闭输出驱动来恢复到安全的结温。图 6-2 展示了电路在过热保护期间的行为。在正常工作期间，器件充当缓冲器，因此输出为 3V。当自热导致器件结温升高超过内部限制时，过热保护强制输出进入高阻抗状态，并通过电阻 R_L 将输出拉至接地。如果依旧存在导致过大功耗的状况，放大器将在关断和启用状态之间振荡，直到输出故障得到纠正。

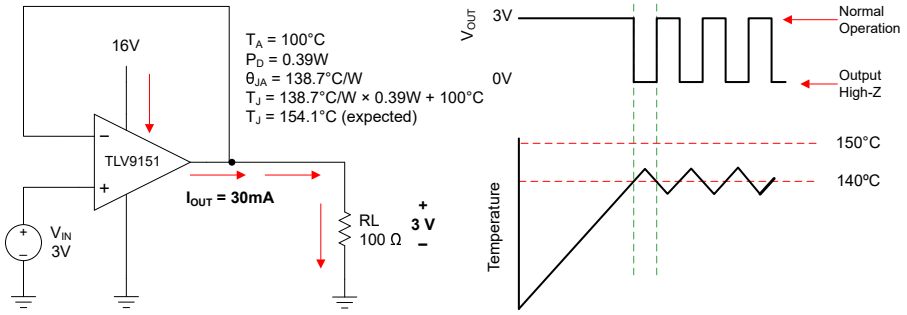


图 6-2. 过热保护

6.3.3 容性负载和稳定性

TLV915x-Q1 具有电阻输出级，能够驱动中等容性负载，而且通过采用隔离电阻器，可以轻松配置该器件来驱动大型容性负载。增加增益可增强放大器驱动更大容性负载的能力；请参阅图 6-3 和图 6-4。当确定放大器运行稳定性时，需要考虑特定运算放大器电路配置、布局、增益和输出负载等因素。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

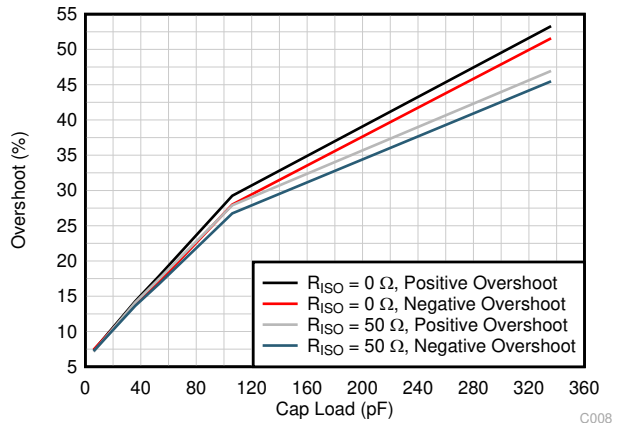


图 6-3. 小信号过冲与容性负载间的关系（10mV 输出阶跃，G = 1）

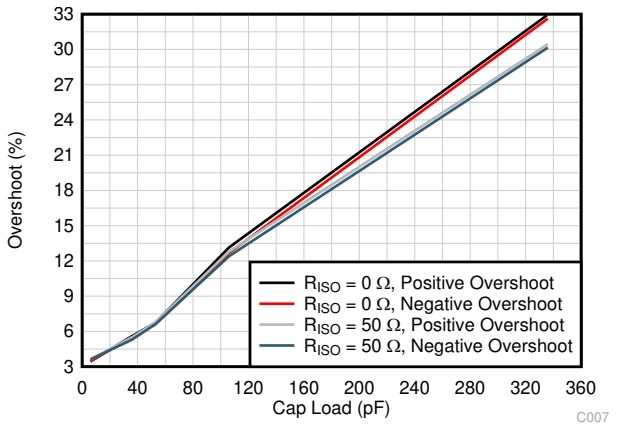


图 6-4. 小信号过冲与容性负载间的关系（10mV 输出阶跃，G = -1）

为了在单位增益配置中获得额外的驱动能力，通过在输出中串联一个小电阻器 R_{ISO} 来提高容性负载驱动能力，如图 6-5 中所示。此电阻器可显著减少振铃，并保持纯容性负载的直流性能。但是，如果电阻负载与容性负载并联，则会产生一个电压分压器，从而在输出端引入增益误差并略微减小输出摆幅。引入的误差与 R_{ISO} / R_L 的比率成正比，在低输出电平下通常可忽略不计。高容性负载驱动使 TLV915x-Q1 非常适合用于基准缓冲器、MOSFET 栅极驱动器和电缆屏蔽驱动器等应用。图 6-5 中所示的电路采用隔离电阻器 R_{ISO} 来稳定运算放大器的输出。R_{ISO} 会修改系统的开环增益，因而能够带来更高的相位裕度。

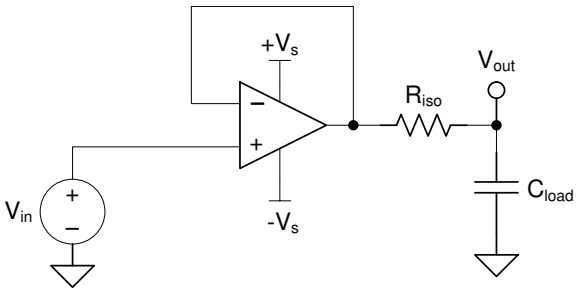


图 6-5. 使用 TLV9151-Q1 扩展容性负载驱动

6.3.4 共模电压范围

TLV915x-Q1 是一个 16V 的轨到轨输入运算放大器，其输入共模范围在任一电源轨之外扩展了 200mV。此宽范围通过并联互补的 N 沟道和 P 沟道差分输入对实现，如图 6-6 所示。当输入电压接近正电源轨（通常从 (V+) – 1V 至高于正电源 100mV）时，N 通道对有效。当输入电压为低于负电源电压 100mV 到大约 (V+) – 2V 时，P 沟道对有效。有一个小转换区域，通常从 (V+) – 2V 至 (V+) – 1V，在这个区间内两个输入对均打开。此转换区域可能会随工艺不同而略有波动；在该区域内，与该区域外的运行相比，以下因素可能会降低：

- PSRR
- CMRR
- 失调电压
- 温漂
- 噪声
- THD 性能

图 5-5 更详细地显示了典型器件在输入电压失调方面的转换区域。

有关共模电压范围和 PMOS/NMOS 对相互作用的更多信息，请参阅*具有互补对输入级的运算放大器* 应用手册。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

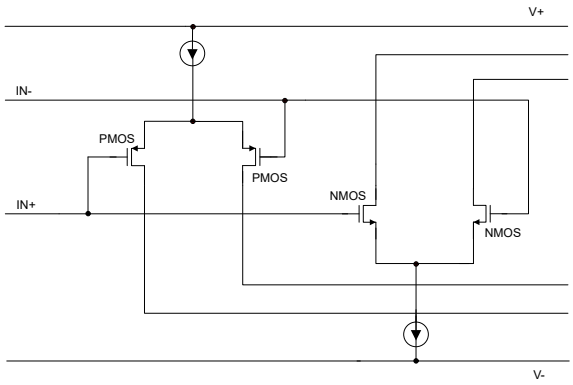


图 6-6. 轨到轨输入级

6.3.5 反相保护

TLV915x-Q1 系列具有内部相位反转保护。当输入被驱动至超过其线性共模范围时，很多运算放大器都会出现相位反转。这是同相电路中输入驱动超出额定共模电压范围时常见的现象，会导致输出反向进入相对的电源轨。TLV915x-Q1 是一款轨至轨输入运算放大器；因此，共模范围可扩展至电源轨。电源轨之外的输入信号不会导致相位反转；相反，输出限制在适当的电源轨中。图 6-7 展示了该性能。有关相位反转的更多信息，请参阅*具有互补对输入级的运算放大器* 应用手册。

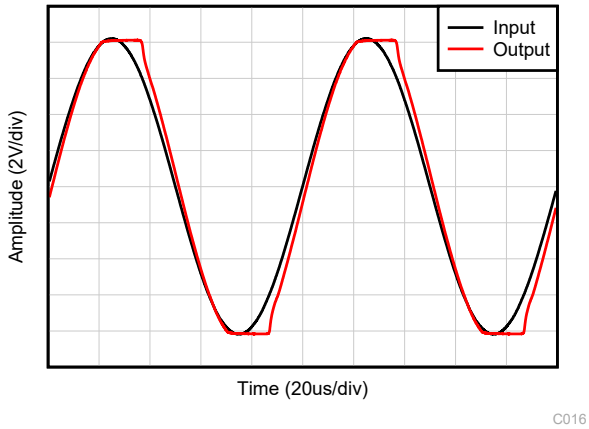


图 6-7. 无相位反转

6.3.6 电过应力

设计人员常常会问到有关运算放大器承受电气过应力 (EOS) 的能力的问题。这些问题侧重于器件输入，同时也会涉及电源引脚甚至输出引脚。这些不同引脚功能的每一个功能具有由独特的半导体制造工艺和连接到引脚的特定电路确定的电气过载限值。此外，这些电路均内置内部静电放电 (ESD) 保护功能，可在产品组装之前和组装过程中保护电路不受意外 ESD 事件的影响。

能够充分了解该基本 ESD 电路及其与电气过应力事件的关联性会有所帮助。图 6-8 展示了 TLV915x-Q1 中包含的 ESD 电路（用虚线区域指示）。ESD 保护电路涉及从输入和输出引脚连接并路由回内部供电线路的数个导流二极管，其中二极管在吸收器件或电源 ESD 单元（运算放大器的内在部分）处相接。该保护电路在电路正常工作时处于未运行状态。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

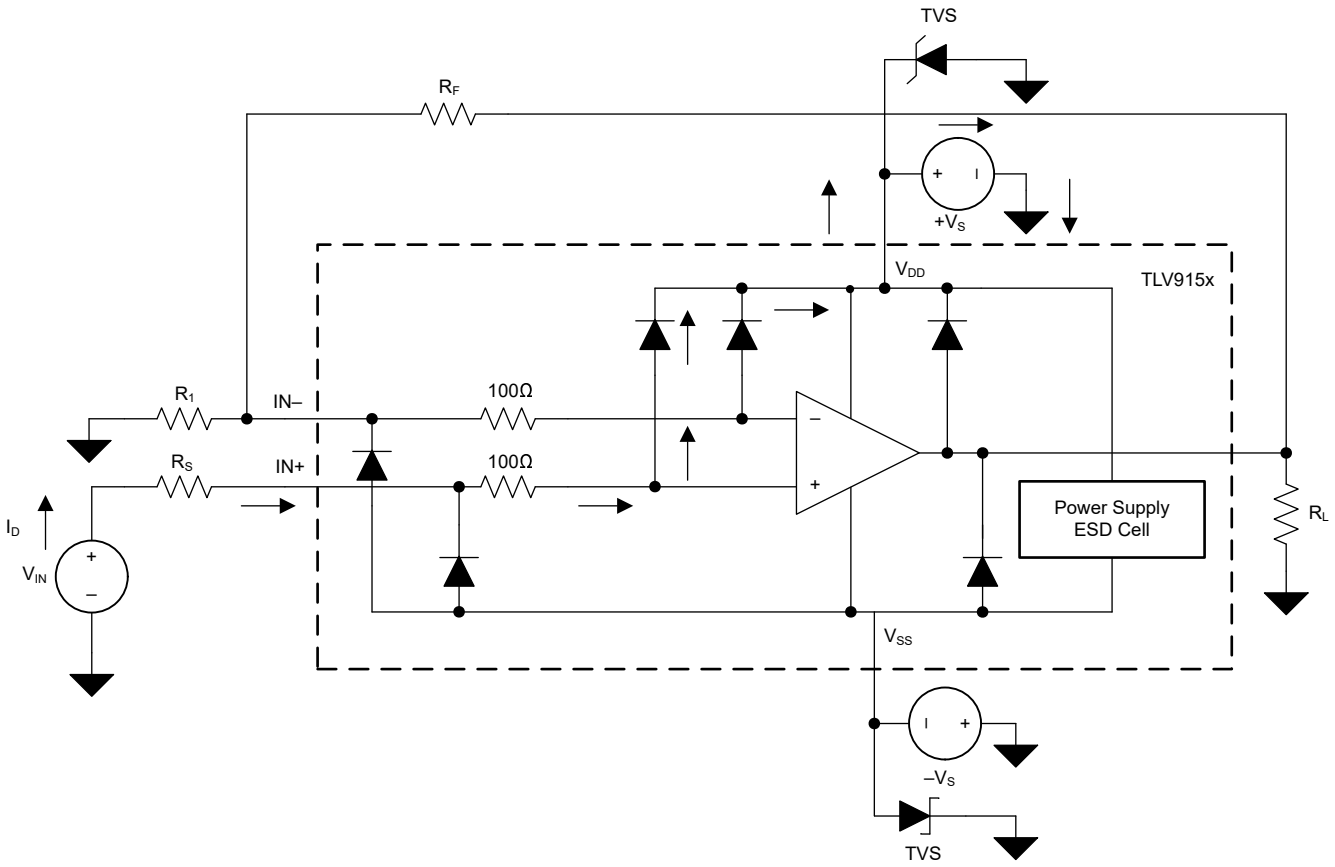


图 6-8. 与典型电路应用相关的等效内部 ESD 电路

ESD 事件持续时间非常短，电压非常高（例如，1kV，100ns），而 EOS 事件持续时间长，电压较低（例如，50V，100ms）。ESD 二极管设计用于电路外 ESD 保护（即在器件被焊接到 PCB 上之前的组装、测试和贮存阶段）。在 ESD 事件中，ESD 信号通过 ESD 导流二极管传递给吸收电路（列为 ESD 电源电路）。ESD 吸收电路将电源钳制在一个安全的水平。

尽管这种行为对于电路外保护来说是必要的，但如果在电路内激活，则会导致过流和损坏。瞬态电压抑制器 (TVS) 可用于防止电路内 ESD 事件中因打开 ESD 吸收电路而导致的损坏。使用适当的限流电阻和 TVS 二极管则允许使用器件 ESD 二极管来防止 EOS 事件。

6.3.7 过载恢复

过载恢复的定义是运算放大器输出从饱和状态恢复到线性状态所需的时间。当输出电压由于高输入电压或高增益而超过额定工作电压时，运算放大器的输出器件进入饱和区。器件进入饱和区后，输出器件中的电荷载体需要时间返回到线性状态。当电荷载体返回到线性状态时，器件开始以指定的压摆率进行转换。因此，过载时的传播延迟等于过载恢复时间与转换时间的总和。TLV915x-Q1 的过载恢复时间大约为 400ns。

6.3.8 典型规格与分布

设计人员经常会对放大器的典型规格提出质疑，以便设计出更稳健的电路。由于工艺技术和制造过程上存在自然差异，因此放大器的每种规格都与适当值存在一定的偏差，例如放大器的输入失调电压。这些偏差通常遵循*高斯*（*钟形曲线*）或*正态*分布，即使节 5.7 中没有最小值或最大值规格，电路设计人员也可以利用该信息来确定系统的限值空间。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

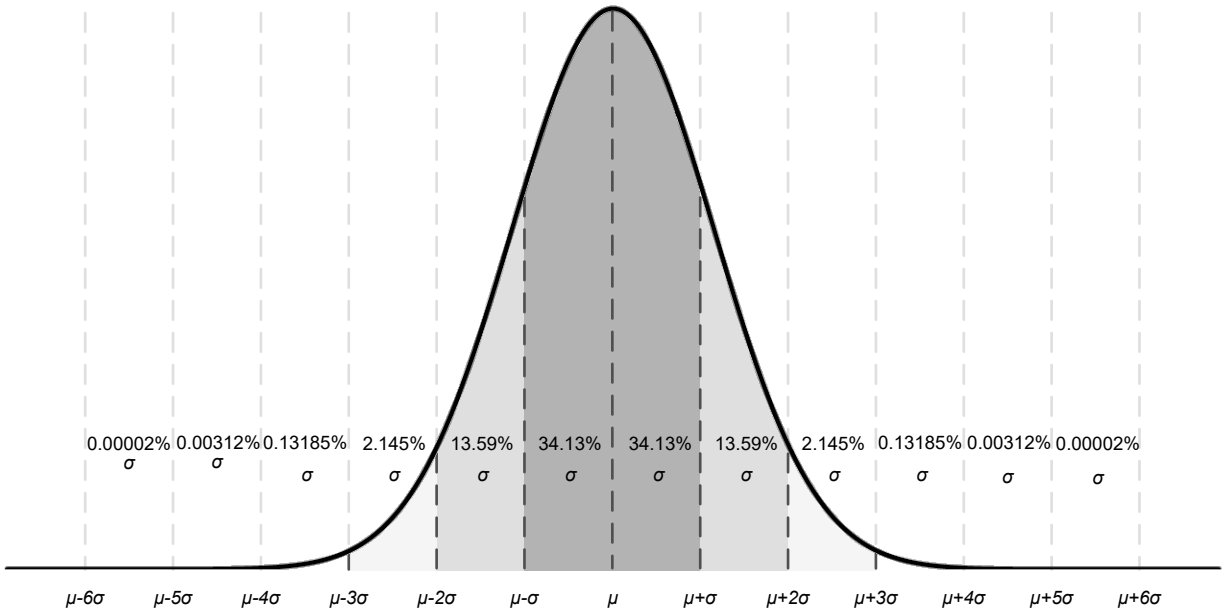


图 6-9. 理想的高斯分布

图 6-9 显示了一个示例分布，其中 μ（或 *mu*）是分布的平均值，σ（或 *sigma*）是系统的标准偏差。对于表现出这种分布的规格，可以预期所有器件中大约三分之二 (68.26%) 的值落在均值的一个标准差（即 1σ）内（从 *μ* – *σ* 到 *μ* + *σ*）。

根据具体规格，节 5.7 的*典型值*一列中列出的值以不同的方式表示。根据一般经验法则，如果规格本身具有非零均值（例如增益带宽），那么典型值等于均值 (μ)。然而，如果规格本身具有接近于零（例如输入失调电压）的均值，那么典型值等于均值加上一个标准偏差 (μ + σ)，这样才能最为准确地表示典型值。

使用该图表来计算器件中某个规格的近似概率；例如，对于 TLV915x-Q1，典型的输入失调电压值为 125μV，因此所有 TLV915x-Q1 器件中有 68.2% 的器件预计都具有 –125μV 至 125μV 的失调电压。在 4 *σ* (±500μV) 条件下，分布的 99.9937% 都具有小于 ±500μV 的失调电压，这意味着总体的 0.0063% 位于这些限值之外，相当于 15,873 个器件有 1 个器件超出该限值。

在最小值或最大值列中具有值的规格由 TI 确保，超过这些限值的器件会从生产材料中剔除。例如，TLV915x-Q1 系列在 25°C 条件下的最大失调电压为 675μV，尽管这相当于约 5σ（约为 170 万个器件中有 1 个器件），可能性微乎其微，但 TI 确保任何失调电压大于 895μV 的器件都将被从生产材料中剔除。

对于最小值或最大值列中没有值的规格，可考虑为应用选择 1σ 值的足够限值空间，并使用此值进行最坏情况下的设计。例如，6σ 值相当于约 5 亿个器件中有 1 个器件，发生的可能性微乎其微，可以作为一个宽限值空间选项来设计系统。在这种情况下，TLV915x-Q1 系列在失调电压漂移上没有最大值和最小值，但根据图 5-2 和节 5.7 中 0.3μV/°C 的典型值，可以计算出失调电压漂移的 6σ 值约为 1.8μV/°C。在为最坏情况的系统条件进行设计时，使用该值来估计整个温度范围内可能的最坏失调电压，而不用知道实际的最小值或最大值。

然而，随着时间的推移，工艺差异和调整会改变典型的均值和标准偏差，除非最小值或最大值规格列中给出了值，否则 TI 无法保证器件的性能。仅使用此信息来估算器件的性能。

6.3.9 关断

TLV915xS-Q1 器件具有一个或多个关断引脚 (SHDN)，该引脚可禁用运算放大器，从而将其置于低功耗待机模式。在该模式下，运算放大器的电流消耗通常约为 30μA。SHDN 引脚为高电平有效，这意味着当 SHDN 引脚的输入为有效逻辑高电平时会启用关断模式。

SHDN 引脚以运算放大器的负电源轨为基准。关断特性的阈值位于 800mV（典型值）左右，且不随电源电压的变化而变化。开关阈值中包含迟滞，可保持顺畅的开关特性。为了实现正确的关断行为，请使用有效逻辑信号驱动

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

SHDN 引脚。有效逻辑低电平的定义是 V– 到 V– + 0.2V 的电压。有效逻辑高电平的定义是 V– + 1.1V 到 V+ 的电压。关断引脚电路包括下拉电阻器，如果不驱动，下拉电阻器会固有地将引脚电压拉至负电源轨。因此，要启用放大器，SHDN 引脚应该保持悬空或被驱动至有效逻辑低电平。要禁用放大器，SHDN 引脚必须被驱动至有效逻辑高电平。SHDN 引脚上允许的最大电压为 V+。超过此电压水平会导致器件损坏。

SHDN 引脚为高阻抗 CMOS 输入。单通道运算放大器和双通道运算放大器封装的各个通道均是单独控制的，而四通道运算放大器封装的通道是成对控制的。对于电池供电应用，使用此特性可大幅降低平均电流并延长电池寿命。关断的典型启用时间为 8 µs；禁用时间为 3 µs。禁用时，输出呈现高阻抗状态。借助该架构，TLV915xS-Q1 产品系列可用作选通放大器、多路复用器或可编程增益放大器。关断时间 (t_{OFF}) 取决于负载条件，并随负载电阻的增加而增加。为了保持在特定的关断时间内关断（禁用），指定的 10kΩ 负载需加载到中间电源 (V_S/2)。如果在没有负载的情况下使用 TLV915xS-Q1，则产生的关断时间会显著增加。

6.4 器件功能模式

TLV915x-Q1 有一个功能模式，可在电源电压大于 2.7V (±1.35V) 时工作。TLV915x-Q1 的最大电源电压为 16V (±8V)。

TLV915xS-Q1 器件具有关断引脚，用于将运算放大器置于低功耗模式。有关更多信息，请参阅节 6.3.9。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

7 应用和实施

备注

以下应用部分中的信息不属于 TI 器件规格的范围，TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客 户应负责确定器件是否适用于其应用。客户应验证并测试其设计，以确保系统功能。

7.1 应用信息

TLV915x-Q1 系列提供了出色的直流精度和直流性能。这些器件的工作电压高达 16V，并提供真正的轨到轨输入/输出、低失调电压、失调电压漂移以及 4.5MHz 带宽和高输出驱动。这些特性使 TLV915x-Q1a 成为一款适用于高电压工业应用且稳定可靠的高性能运算放大器。

7.2 典型应用

7.2.1 低侧电流测量

图 7-1 展示了低侧电流检测应用中配置的 TLV9151-Q1。有关图 7-1 中所示电路的全面分析，包括理论、计算、模拟和测量数据，请参阅 TI 精密设计 TIPD129 *0A 至 1A 单电源低侧电流检测解决方案*。

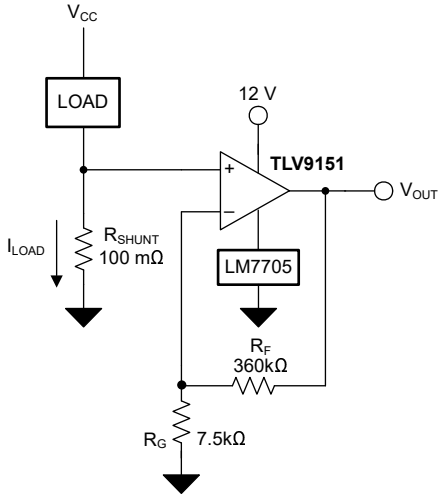


图 7-1. 低侧电流检测应用中的 TLV9151-Q1

7.2.1.1 设计要求

此设计的设计要求如下：

- 负载电流：0A 至 1A
- 输出电压：4.9V
- 最大分流电压：100mV

7.2.1.2 详细设计过程

方程式 1 提供了图 7-1 中的电路传递函数。

$$V_{OUT} = I_{LOAD} \times R_{SHUNT} \times Gain \quad (1)$$

负载电流 (I_{LOAD}) 在分流电阻器 (R_{SHUNT}) 上产生压降。负载电流为 0A 至 1A。为了在最大负载电流下保持分流电压低于 100mV，方程式 2 定义了最大分流电阻。

$$R_{SHUNT} = \frac{V_{SHUNT_MAX}}{I_{LOAD_MAX}} = \frac{100\ m\ V}{1\ A} = 100 m\Omega \quad (2)$$

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

使用方程式 2，计算出的 R_{SHUNT} 为 100mΩ。I_{LOAD} 和 R_{SHUNT} 产生的压降由 TLV9151-Q1 放大，从而产生 0V 至 4.9V 输出电压。使用方程式 3 计算 TLV9151-Q1 生成必要输出电压所需的增益。

$$\text{Gain} = \frac{\left(V_{OUT_MAX} - V_{OUT_MIN}\right)}{\left(V_{IN_MAX} - V_{IN_MIN}\right)} \quad (3)$$

使用方程式 3，所需增益为 49V/V，该值由电阻器 R_F 和 R_G 设置。使用方程式 4 确定 R_F 和 R_G 电阻器的大小，从而将 TLV9151-Q1 的增益设置为 49V/V。

$$\text{Gain} = 1 + \frac{\left(R_F\right)}{\left(R_G\right)} \quad (4)$$

选择 R_F 为 360kΩ 时，计算得出 R_G 为 7.5kΩ。R_F 和 R_G 为 360kΩ 和 7.5kΩ，因为其是标准值电阻器，可产生 49:1 的比率。也可以使用可产生 49:1 比率的其他电阻器。图 7-2 展示了图 7-1 中所示电路测得的传递函数。

7.2.1.3 应用曲线

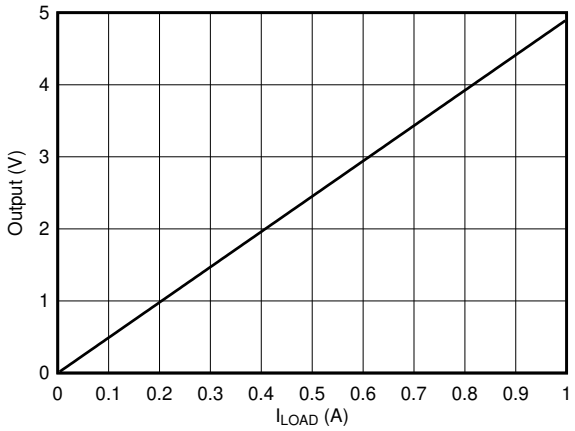


图 7-2. 低侧电流感测传递函数

7.3 电源相关建议

TLV915x-Q1 的额定工作范围为 2.7V 至 16V（±1.35V 至 ±8V）；多种规格适用于 –40°C 至 125°C 的温度范围。节 5.8 包括可能会随工作电压或温度的变化而显著变化的参数。

小心

电源电压超过 16V 可能会对器件造成永久损坏；请参阅节 5.1。

将 0.1µF 旁路电容器置于电源引脚附近，以减少来自高噪声电源或高阻抗电源的耦合误差。更多有关旁路电容器放置的详细信息，请参阅节 7.4。

7.4 布局

7.4.1 布局指南

为了实现器件的出色工作性能，请采用良好的 PCB 布局实践，包括：

- 噪声可以通过整个电路和运算放大器的电源引脚传入模拟电路中。使用旁路电容器，通过提供模拟电路的本地低阻抗电源来减少耦合噪声。
  - 在每个电源引脚和接地端之间连接低等效串联电阻 (ESR) 0.1µF 陶瓷旁路电容器，并尽量靠近器件放置。针对单电源应用，V+ 与接地端之间可以接入单个旁路电容器。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

- 将电路中的模拟部分和数字部分单独接地是最简单、最有效的噪声抑制方法之一。多层 PCB 上的一层或多层通常专门用于作为接地平面。接地层有助于散热和减少 EMI 噪声拾取。确保对数字接地和模拟接地进行物理隔离，同时应注意接地电流的流动。
- 为了减少寄生耦合，应让输入走线尽可能远离电源或输出走线。如果这些走线无法分开，将敏感走线与噪声走线垂直交叉，而非平行布设，效果要好得多。
- 外部元件应尽量靠近器件放置。如图 7-4 所示，使 RF 和 RG 靠近反相输入可更大限度减小寄生电容。
- 尽可能缩短输入走线的长度。切记，输入布线是电路中最敏感的部分。
- 考虑在关键布线周围设定驱动型低阻抗保护环。这样可显著减少附近布线在不同电势下产生的漏电流。
- 为获得卓越性能，建议在组装 PCB 板后进行清洁。
- 任何精密集成电路都可能因湿气渗入塑料封装中而出现性能变化。在执行任何 PCB 水清洁流程之后，建议将 PCB 组件烘干，以去除清洁时渗入器件封装中的水分。大多数情形下，清洁后在 85°C 下低温烘干 30 分钟即可。

7.4.2 布局示例

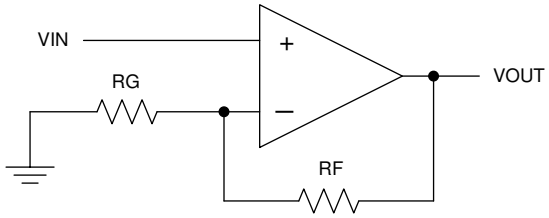


图 7-3. 原理图表示

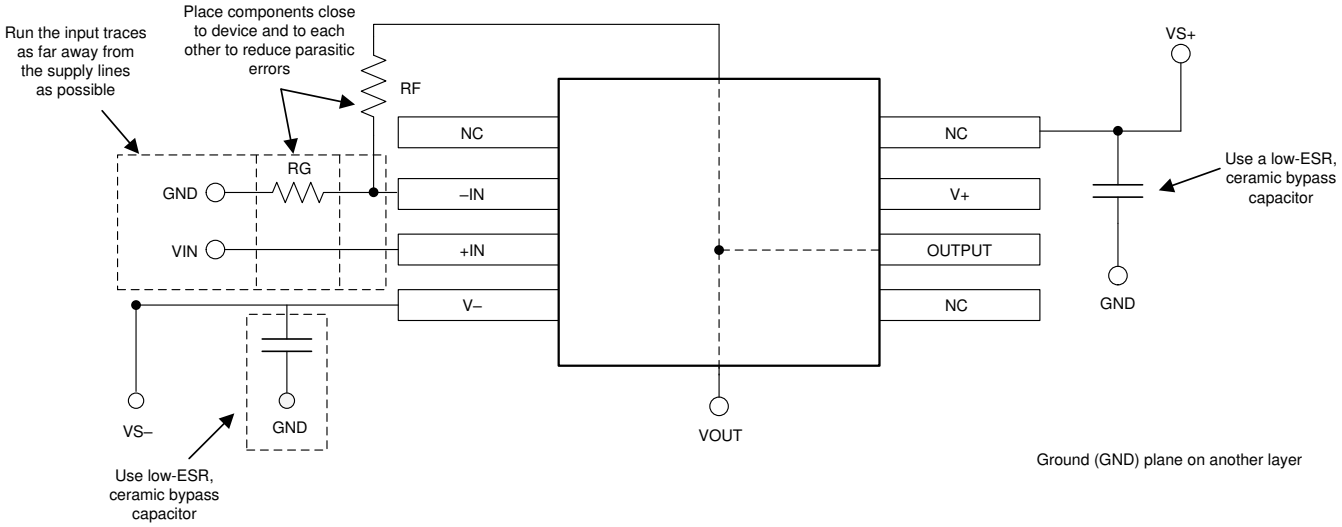


图 7-4. 同相配置的运算放大器电路板布局

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

8 器件和文档支持

8.1 器件支持

8.1.1 开发支持

8.1.1.1 TINA-TI™（免费软件下载）

TINA™ 是一款基于 SPICE 引擎的 简单、功能强大且易于使用的电路仿真程序。TINA-TI 是 TINA 软件的一款免费全功能版本，除了一系列无源和有源模型外，此版本软件还预先载入了一个宏模型库。TINA-TI 提供所有传统的 SPICE 直流、瞬态和频域分析，以及其他设计功能。

TINA-TI 可通过模拟电子实验室设计中心免费下载，该软件提供了丰富的后处理能力，允许用户以各种方式格式化结果。虚拟仪器提供选择输入波形和探测电路节点、电压以及波形的能力，从而构建一个动态的快速启动工具。

备注

这些文件要求安装 TINA 软件（从 DesignSoft™）或者 TINA-TI 软件。请从 TINA-TI 文件夹中下载免费的 TINA-TI 软件。

8.1.1.2 TI 精密设计

TLV915x-Q1 采用多种 TI 高精度设计，有关内容请访问 http://www.ti.com/ww/en/analog/precision-designs/。TI 精密设计是由 TI 公司的精密模拟应用专家创建的模拟解决方案，提供了许多实用电路的工作原理、元件选择、模拟、完整 PCB 电路原理图和布局布线、物料清单以及性能测量结果。

8.2 文档支持

8.2.1 相关文档

如要查看相关文件，请参阅以下内容：

- 德州仪器 (TI)，*模拟工程师电路设计指导手册：放大器* 电子书
- 德州仪器 (TI)，*AN31 放大器电路集合* 应用手册
- 德州仪器 (TI)，TI 精密设计 *0A 至 1A 单电源低侧电流检测解决方案*
- 德州仪器 (TI)，*运算放大器的 EMI 抑制比* 应用手册
- 德州仪器 (TI)，*具有互补对输入级的运算放大器* 模拟设计期刊

8.3 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 ti.com 上的器件产品文件夹。点击*通知* 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

8.4 支持资源

TI E2E™ 中文支持论坛是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的使用条款。

8.5 商标

动力总成™ and TI E2E™ are trademarks of Texas Instruments.
TINA-TI™ is a trademark of Texas Instruments, Inc and DesignSoft, Inc.
TINA™ and DesignSoft™ are trademarks of DesignSoft, Inc.
Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.
所有商标均为其各自所有者的财产。

8.6 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

8.7 术语表

TI 术语表　　本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

9 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

Changes from Revision G (March 2024) to Revision H (October 2026)	Page
• 将关断 V_{IH} 参数从放大器启用更改为放大器禁用	8
• 将关断 V_{IL} 参数从放大器禁用更改为放大器启用	8

Changes from Revision F (June 2023) to Revision G (March 2024)	Page
• 向整个数据表中添加了 6 引脚 SOT-23 (DBV) 和 5 引脚 SC70 (DCK) 封装信息	1
• 为 TLV9151SQDBVRQ1 添加了 HBM ESD 等级	7
• 向“电气特性”表中添加了“关断性能”部分	8
• 向 *特性说明* 中添加了 *关断* 部分	24

10 机械、封装和可订购信息

下述页面包含机械、封装和订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package | Pins	Package qty | Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
TLV9151QDBVRQ1	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	2JKF
TLV9151QDBVRQ1.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	2JKF
TLV9151QDCKRQ1	Active	Production	SC70 (DCK) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	1MT
TLV9151QDCKRQ1.A	Active	Production	SC70 (DCK) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	1MT
TLV9151SQDBVRQ1	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 6	3000 | LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	3BIH
TLV9151SQDBVRQ1.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 6	3000 | LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	3BIH
TLV9152QDGKRQ1	Active	Production	VSSOP (DGK) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	27XT
TLV9152QDGKRQ1.A	Active	Production	VSSOP (DGK) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	27XT
TLV9152QDRQ1	Active	Production	SOIC (D) | 8	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T9152Q
TLV9152QDRQ1.A	Active	Production	SOIC (D) | 8	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T9152Q
TLV9152QPWRQ1	Active	Production	TSSOP (PW) | 8	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	TL9152
TLV9152QPWRQ1.A	Active	Production	TSSOP (PW) | 8	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	TL9152
TLV9154QDRQ1	Active	Production	SOIC (D) | 14	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	TL9154QD
TLV9154QDRQ1.A	Active	Production	SOIC (D) | 14	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	TL9154QD
TLV9154QDYYRQ1	Active	Production	SOT-23-THIN (DYY) | 14	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	TLV9154Q
TLV9154QDYYRQ1.A	Active	Production	SOT-23-THIN (DYY) | 14	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	TLV9154Q
TLV9154QPWRQ1	Active	Production	TSSOP (PW) | 14	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU | SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T9154Q
TLV9154QPWRQ1.A	Active	Production	TSSOP (PW) | 14	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T9154Q

(1) **Status:** For more details on status, see our product life cycle.

(2) **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

(3) **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the TI RoHS Statement for additional information and value definition.

(4) **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

(5) MSL rating/Peak reflow: The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

(6) Part marking: There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

OTHER QUALIFIED VERSIONS OF TLV9151-Q1, TLV9152-Q1, TLV9154-Q1 :

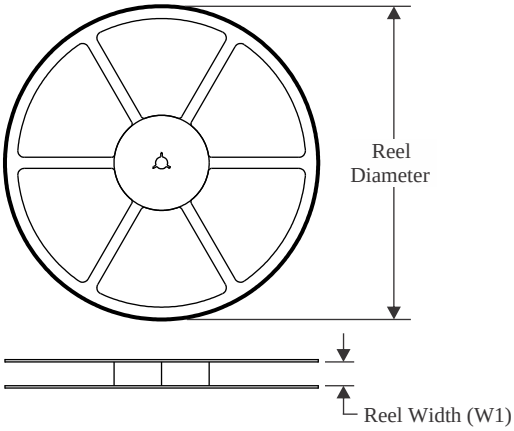
- Catalog : TLV9151, TLV9152, TLV9154

NOTE: Qualified Version Definitions:

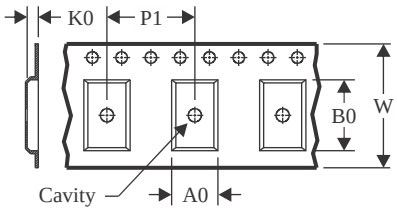
- Catalog - TI's standard catalog product

TAPE AND REEL INFORMATION

REEL DIMENSIONS

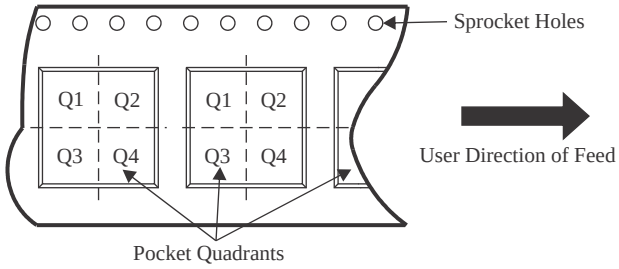


TAPE DIMENSIONS



A0	Dimension designed to accommodate the component width
B0	Dimension designed to accommodate the component length
K0	Dimension designed to accommodate the component thickness
W	Overall width of the carrier tape
P1	Pitch between successive cavity centers

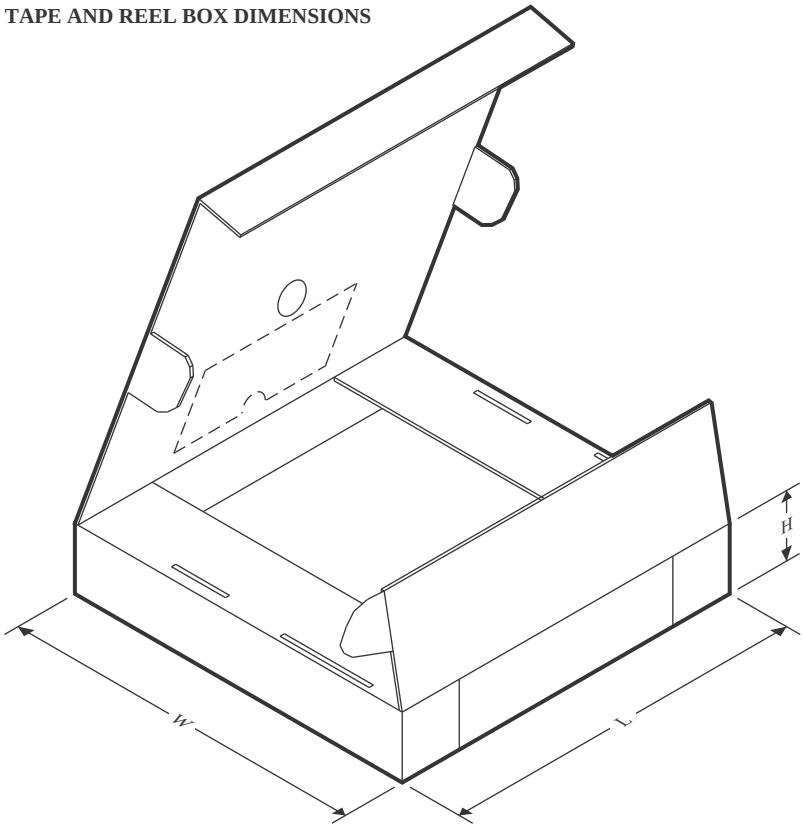
QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
TLV9151QDBVRQ1	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
TLV9151QDBVRQ1	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
TLV9151QDCKRQ1	SC70	DCK	5	3000	178.0	9.0	2.4	2.5	1.2	4.0	8.0	Q3
TLV9151SQDBVRQ1	SOT-23	DBV	6	3000	180.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
TLV9152QDGKRQ1	VSSOP	DGK	8	2500	330.0	12.4	5.3	3.4	1.4	8.0	12.0	Q1
TLV9152QDRQ1	SOIC	D	8	3000	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
TLV9152QPWRQ1	TSSOP	PW	8	3000	330.0	12.4	7.0	3.6	1.6	8.0	12.0	Q1
TLV9154QDRQ1	SOIC	D	14	3000	330.0	16.4	6.5	9.0	2.1	8.0	16.0	Q1
TLV9154QDYYRQ1	SOT-23-THIN	DYY	14	3000	330.0	12.4	4.8	3.6	1.6	8.0	12.0	Q3
TLV9154QPWRQ1	TSSOP	PW	14	3000	330.0	12.4	6.9	5.6	1.6	8.0	12.0	Q1

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



*All dimensions are nominal

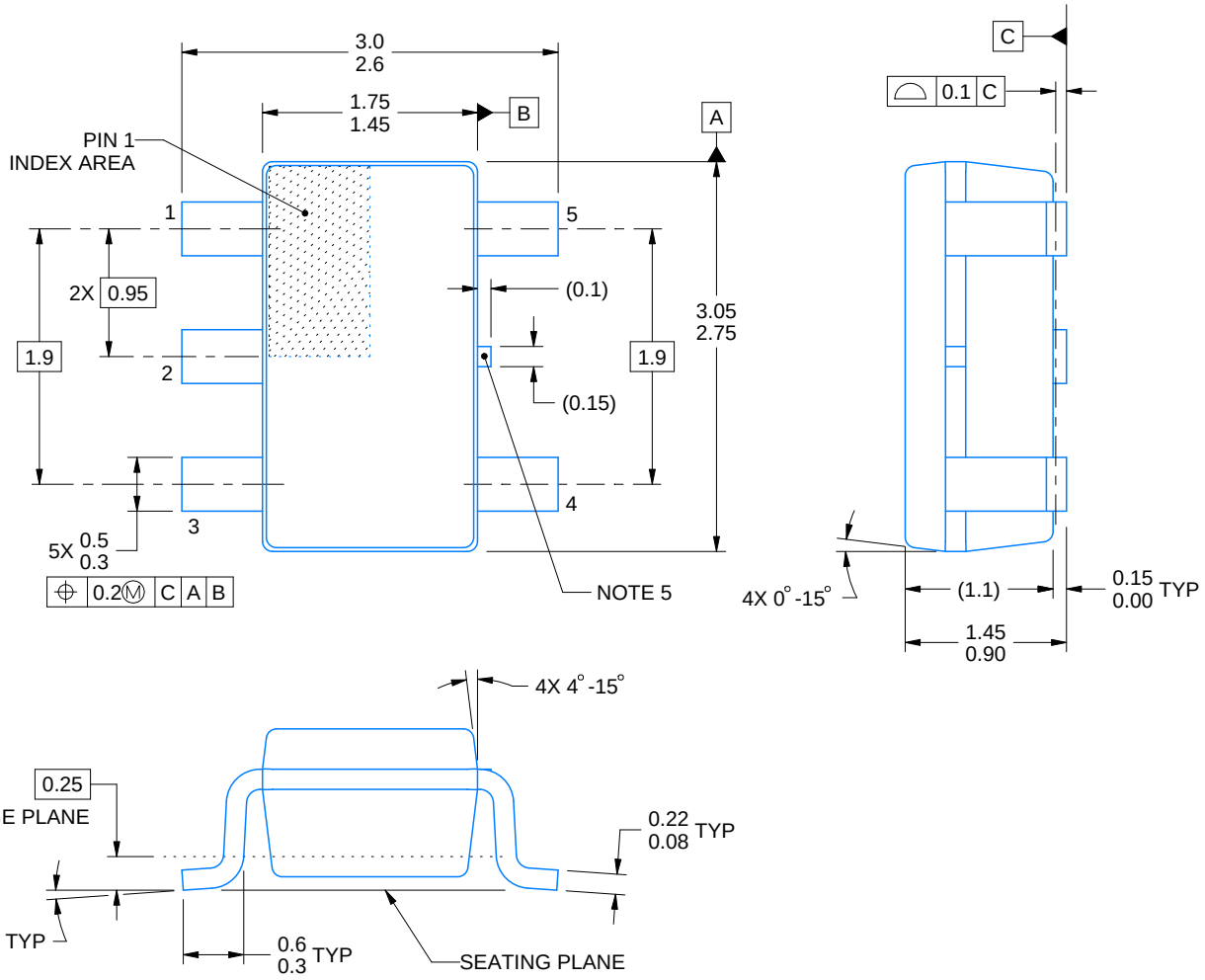
Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
TLV9151QDBVRQ1	SOT-23	DBV	5	3000	210.0	185.0	35.0
TLV9151QDBVRQ1	SOT-23	DBV	5	3000	210.0	185.0	35.0
TLV9151QDCKRQ1	SC70	DCK	5	3000	180.0	180.0	18.0
TLV9151SQDBVRQ1	SOT-23	DBV	6	3000	210.0	185.0	35.0
TLV9152QDGKRQ1	VSSOP	DGK	8	2500	353.0	353.0	32.0
TLV9152QDRQ1	SOIC	D	8	3000	353.0	353.0	32.0
TLV9152QPWRQ1	TSSOP	PW	8	3000	353.0	353.0	32.0
TLV9154QDRQ1	SOIC	D	14	3000	353.0	353.0	32.0
TLV9154QDYYRQ1	SOT-23-THIN	DYY	14	3000	336.6	336.6	31.8
TLV9154QPWRQ1	TSSOP	PW	14	3000	353.0	353.0	32.0

PACKAGE OUTLINE

DBV0005A

SOT-23 - 1.45 mm max height

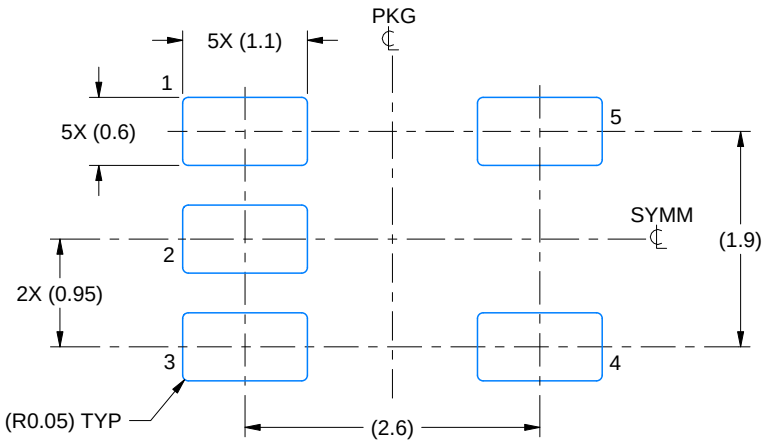
SMALL OUTLINE TRANSISTOR



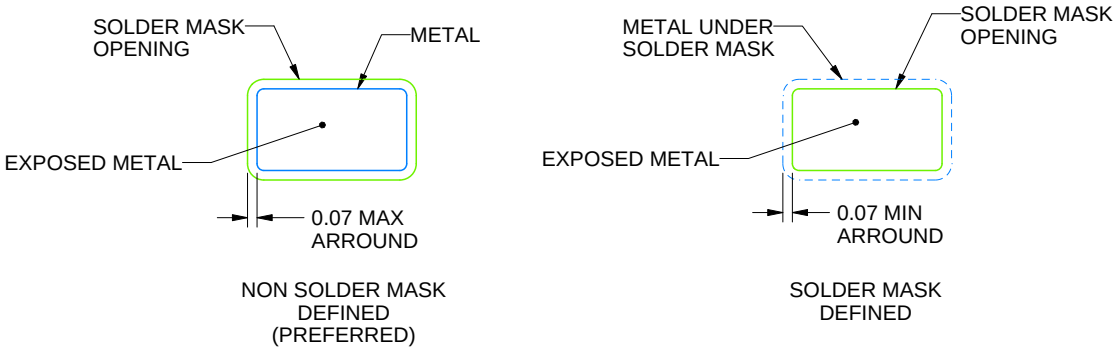
4214839/K 08/2024

NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. Refernce JEDEC MO-178.
4. Body dimensions do not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Support pin may differ or may not be present.



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:15X

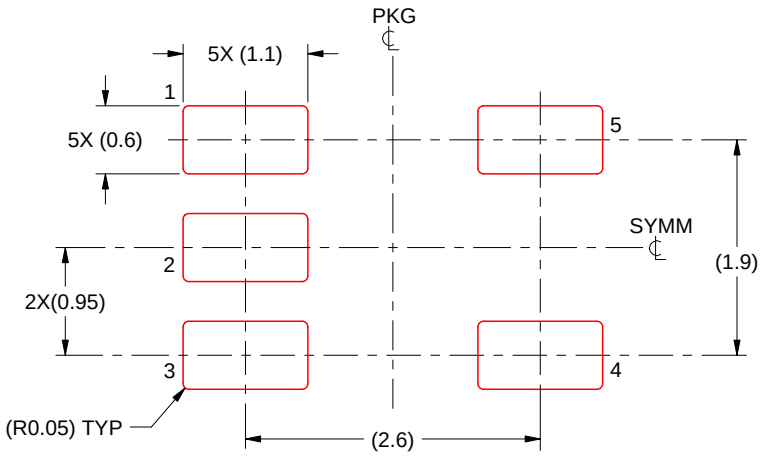


SOLDER MASK DETAILS

4214839/K 08/2024

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE:15X

4214839/K 08/2024

NOTES: (continued)

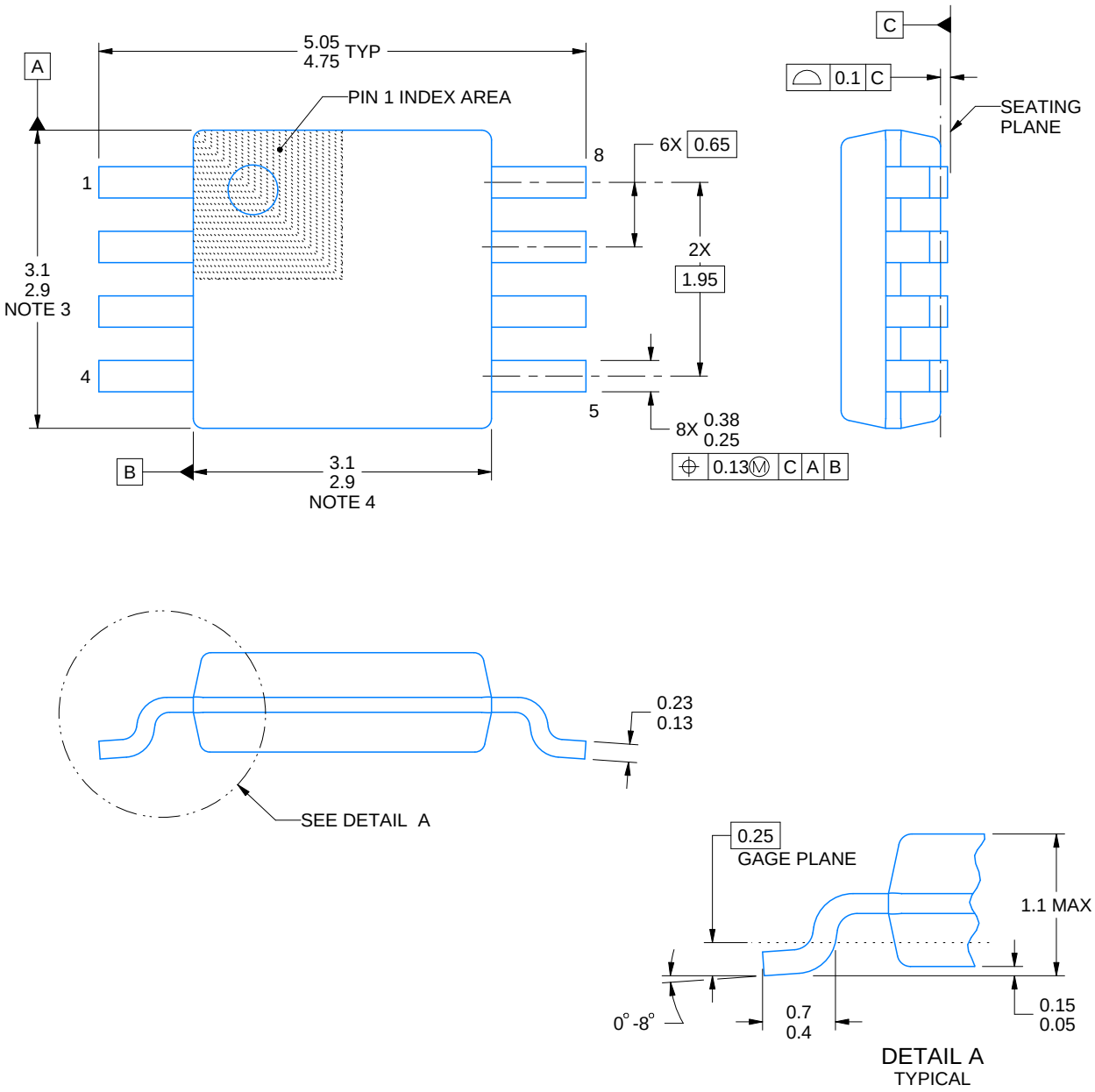
8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

PACKAGE OUTLINE

DGK0008A

VSSOP - 1.1 mm max height

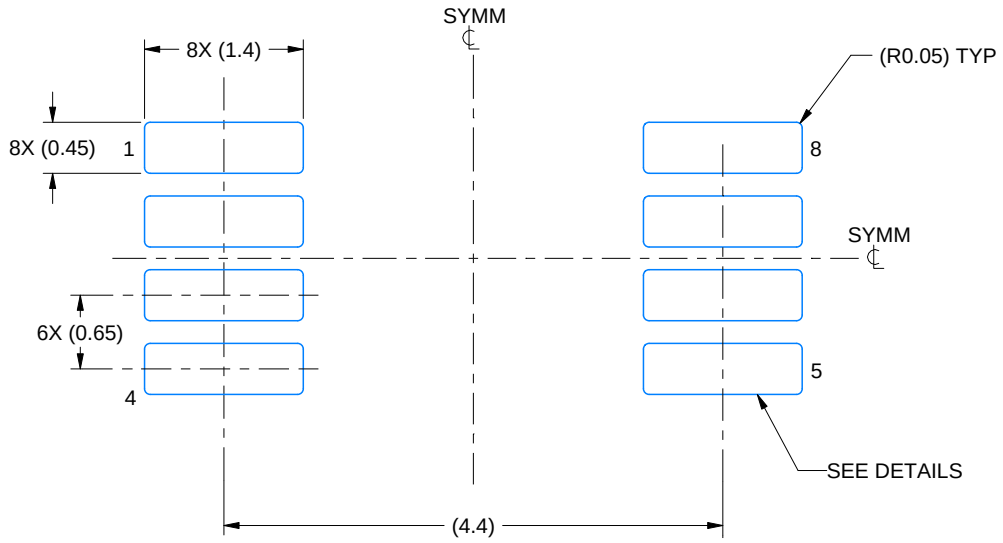
SMALL OUTLINE PACKAGE



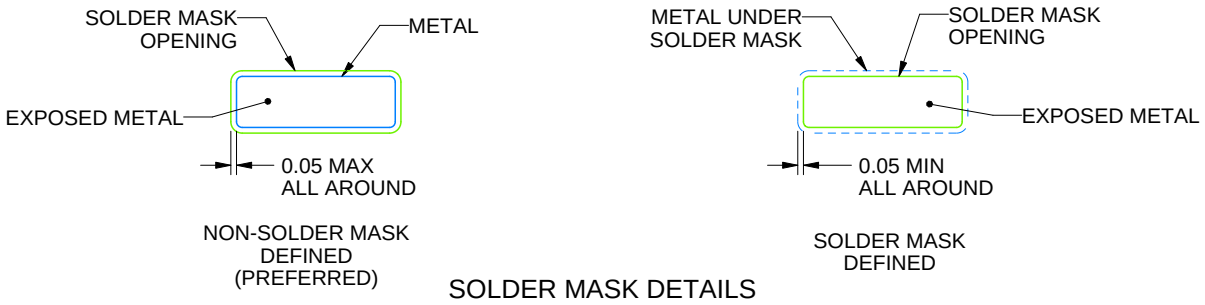
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MO-187.



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 15X

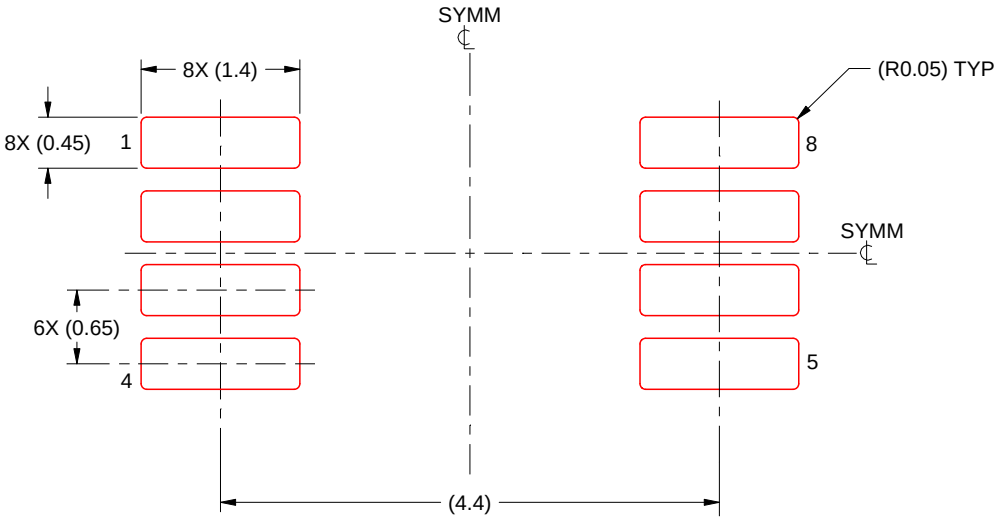


SOLDER MASK DETAILS

4214862/A 04/2023

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.
8. Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. If any vias are implemented, refer to their locations shown on this view. It is recommended that vias under paste be filled, plugged or tented.
9. Size of metal pad may vary due to creepage requirement.



SOLDER PASTE EXAMPLE
SCALE: 15X

4214862/A 04/2023

NOTES: (continued)

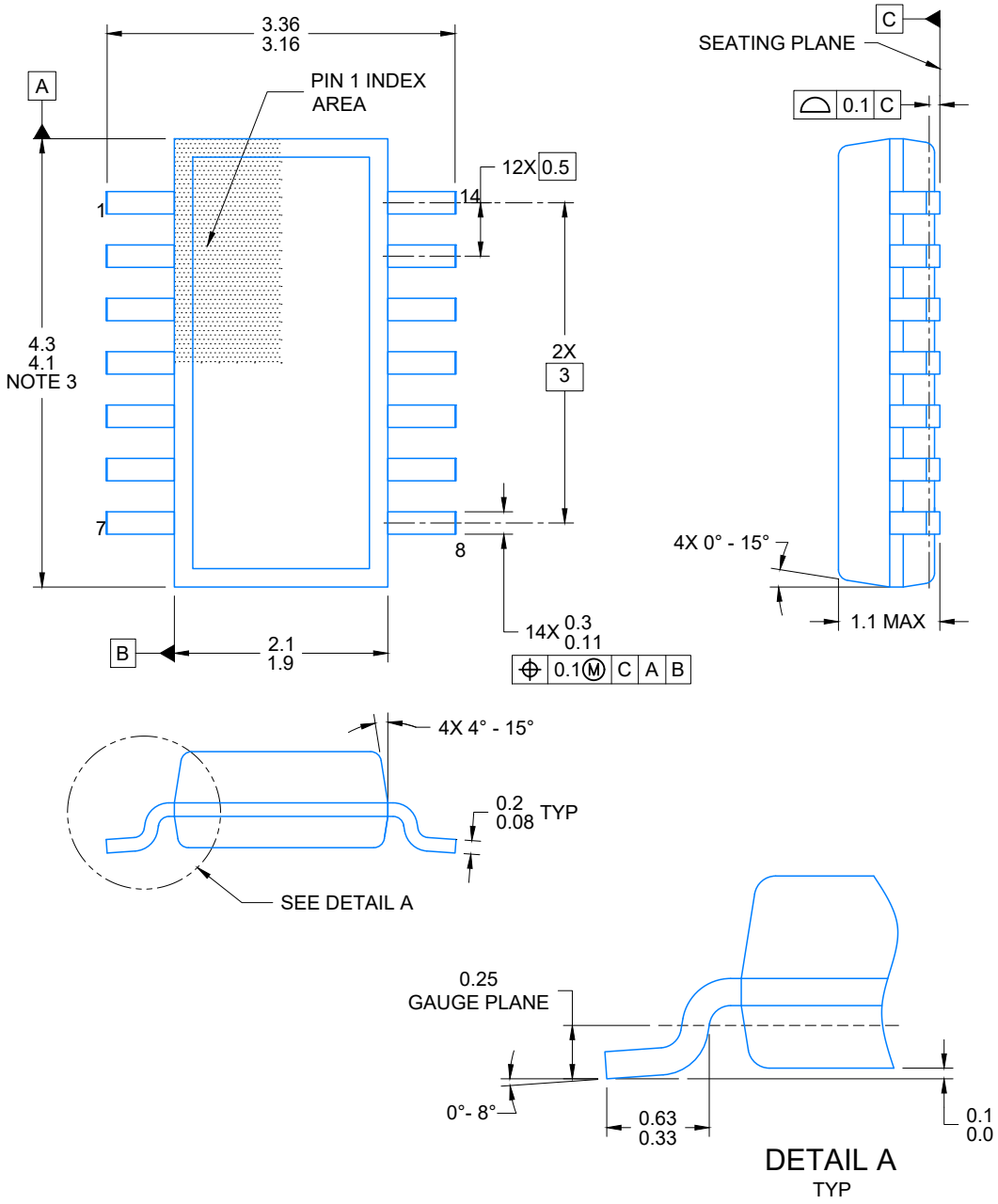
11. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
12. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

PACKAGE OUTLINE

DYY0014A

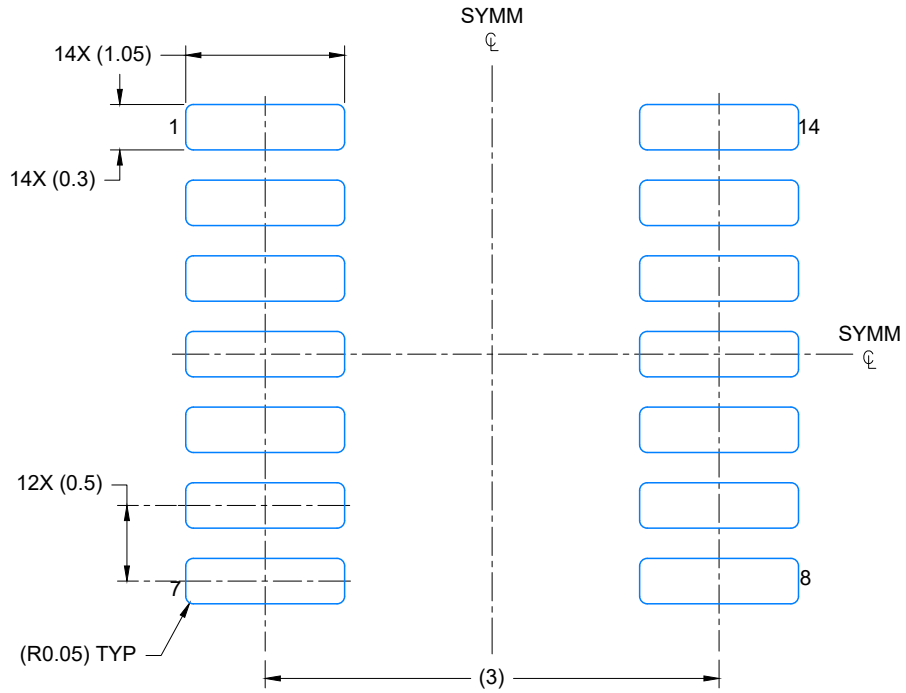
SOT-23-THIN - 1.1 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE

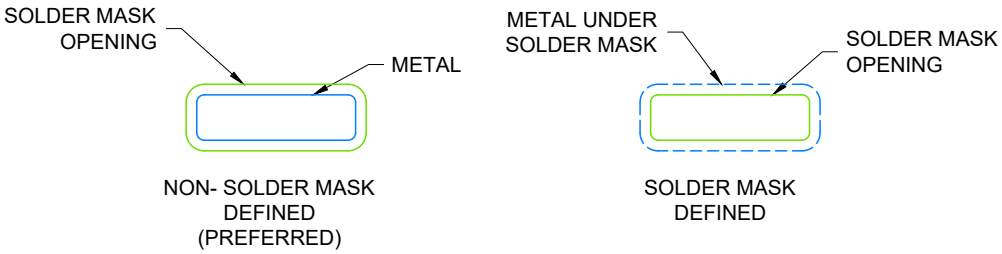


NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.50 per side.
5. Reference JEDEC Registration MO-345, Variation AB



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 20X

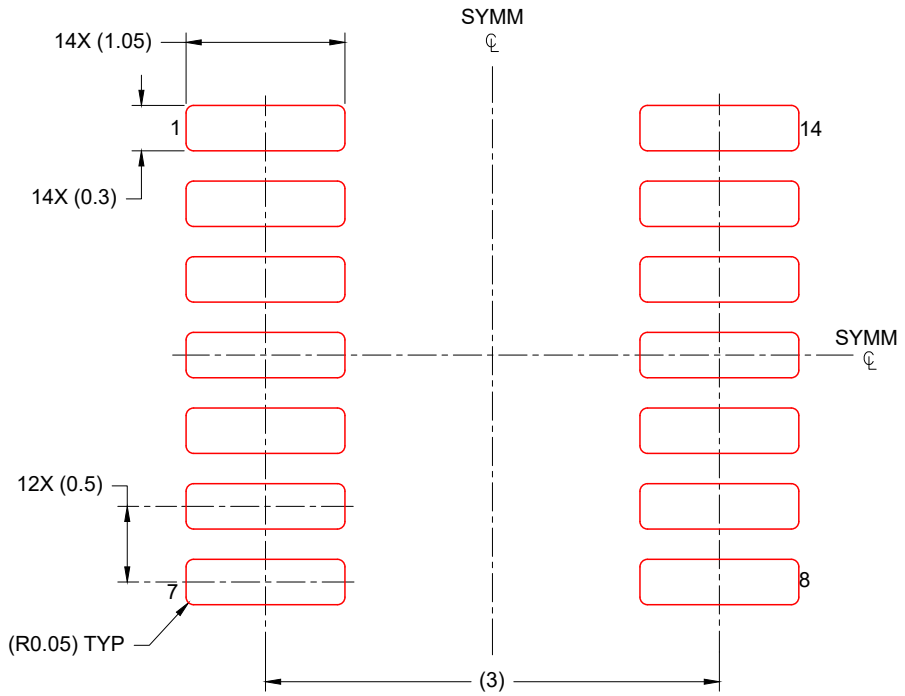


SOLDER MASK DETAILS

4224643/D 07/2024

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

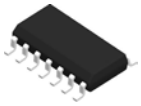


SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE: 20X

4224643/D 07/2024

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

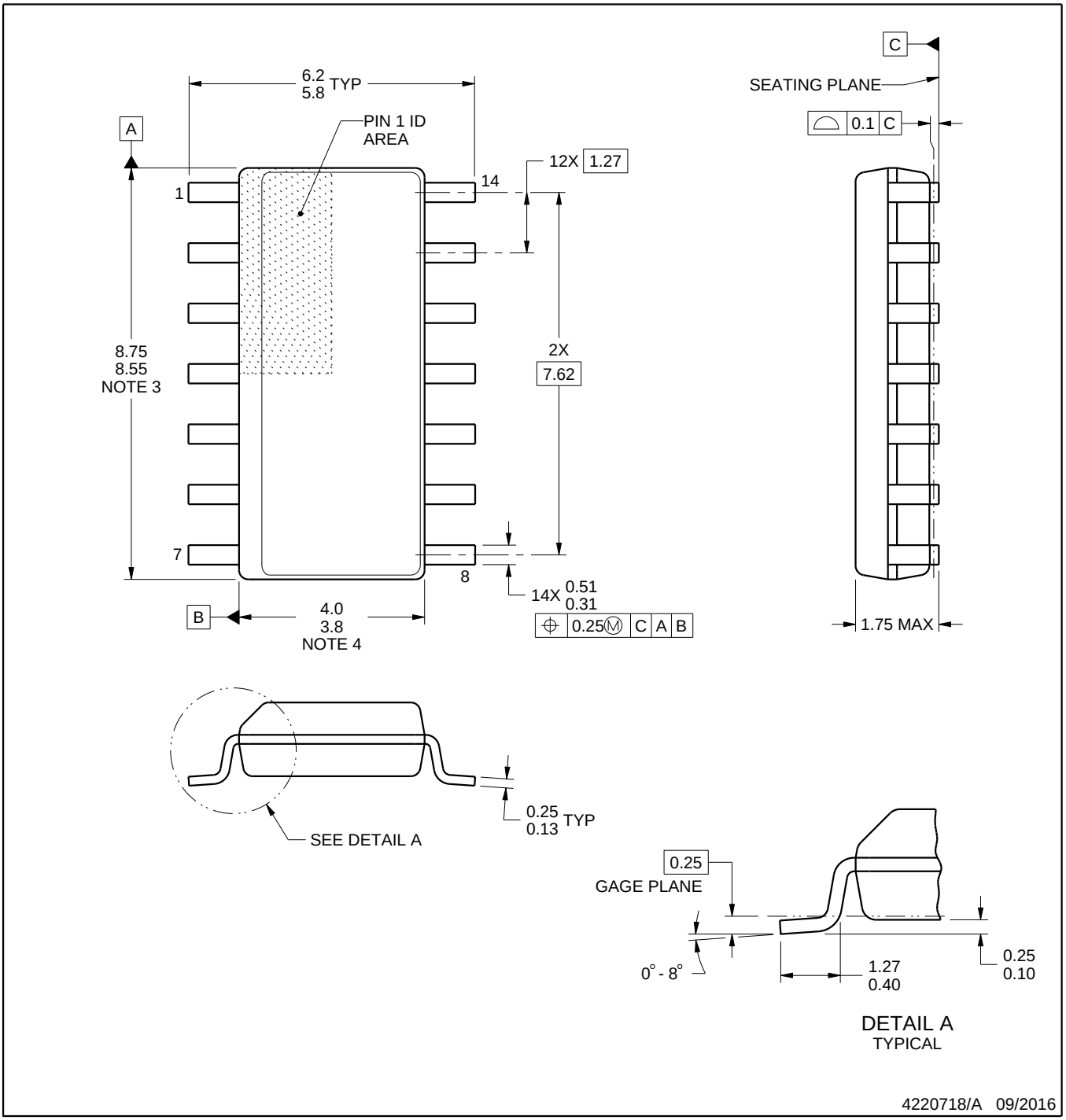


PACKAGE OUTLINE

D0014A

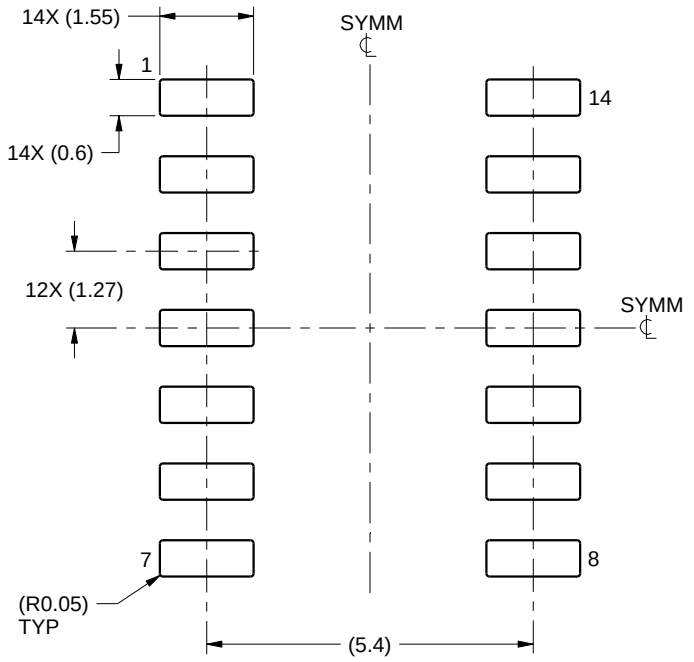
SOIC - 1.75 mm max height

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT

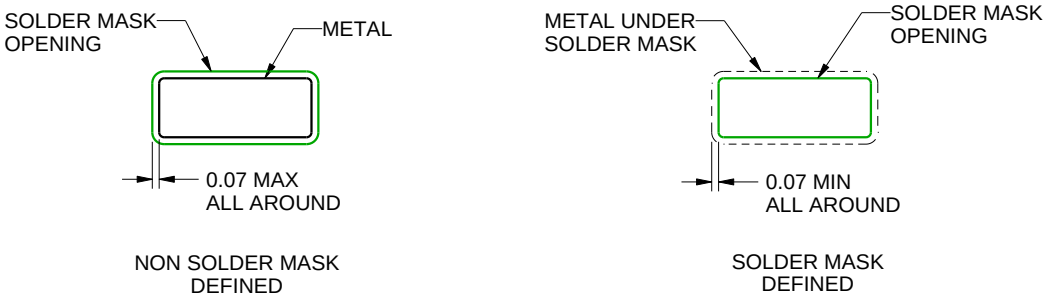


NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm, per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.43 mm, per side.
5. Reference JEDEC registration MS-012, variation AB.



LAND PATTERN EXAMPLE
SCALE:8X



SOLDER MASK DETAILS

4220718/A 09/2016

NOTES: (continued)

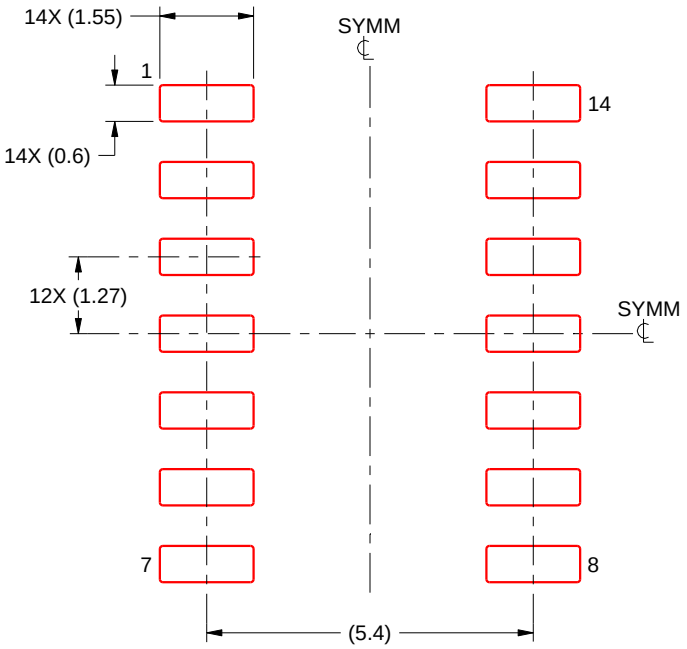
6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

D0014A

SOIC - 1.75 mm max height

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE:8X

4220718/A 09/2016

NOTES: (continued)

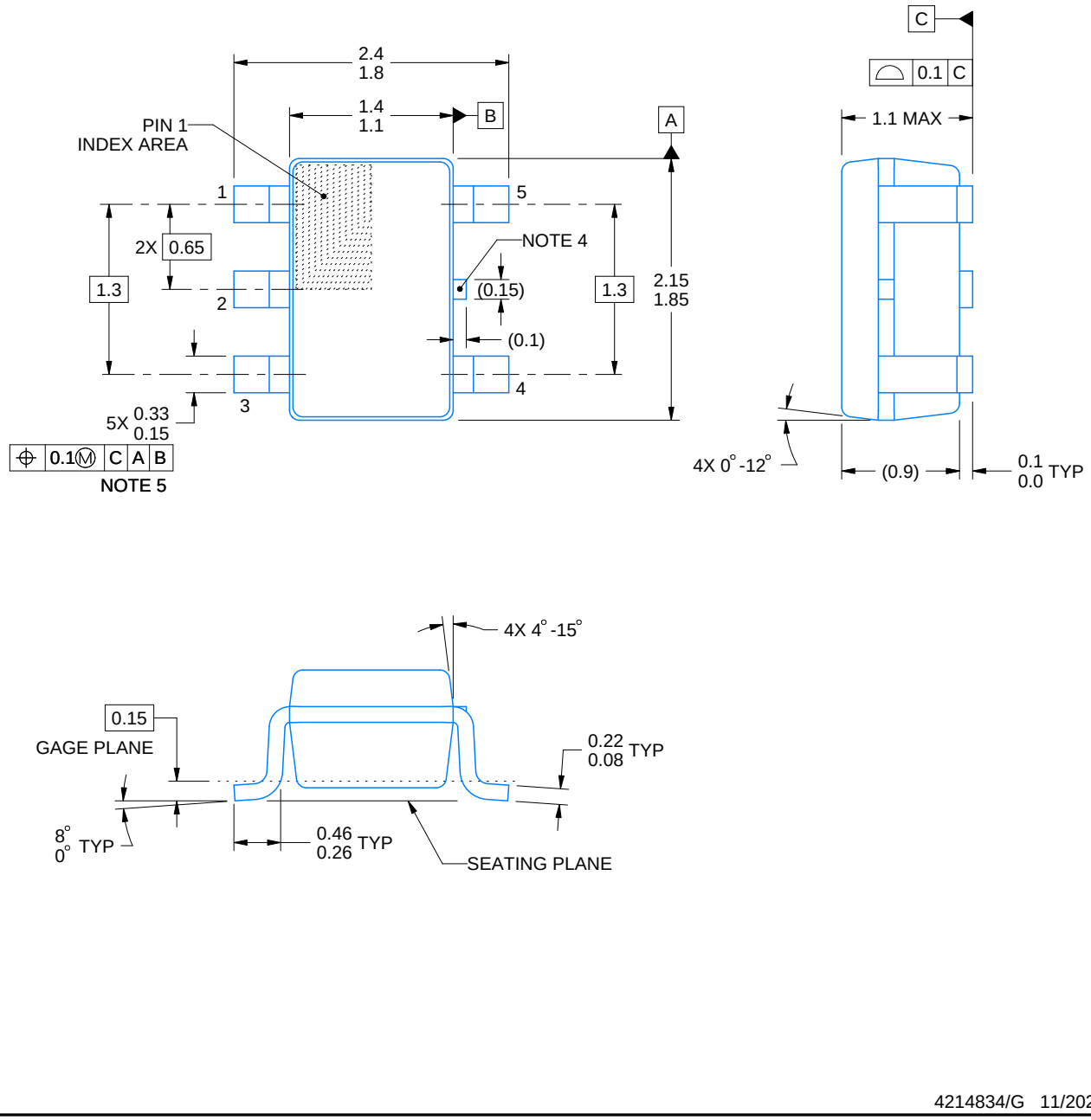
8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

PACKAGE OUTLINE

DCK0005A

SOT - 1.1 max height

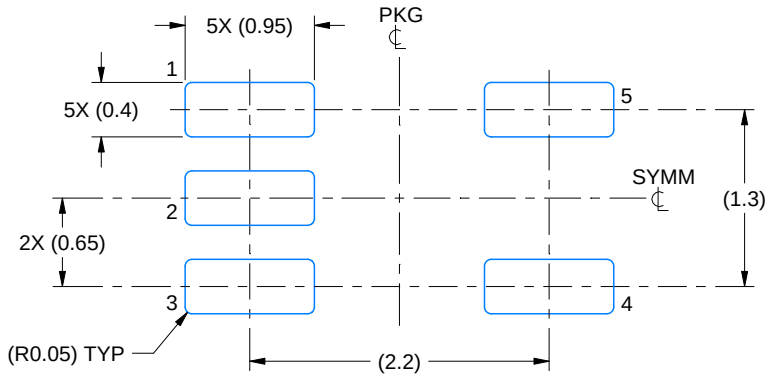
SMALL OUTLINE TRANSISTOR



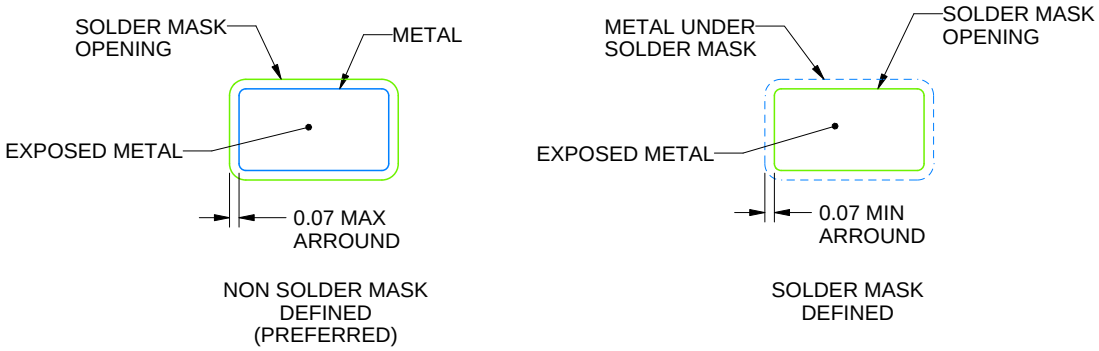
4214834/G 11/2024

NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. Refernce JEDEC MO-203.
4. Support pin may differ or may not be present.
5. Lead width does not comply with JEDEC.
6. Body dimensions do not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.25mm per side



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:18X

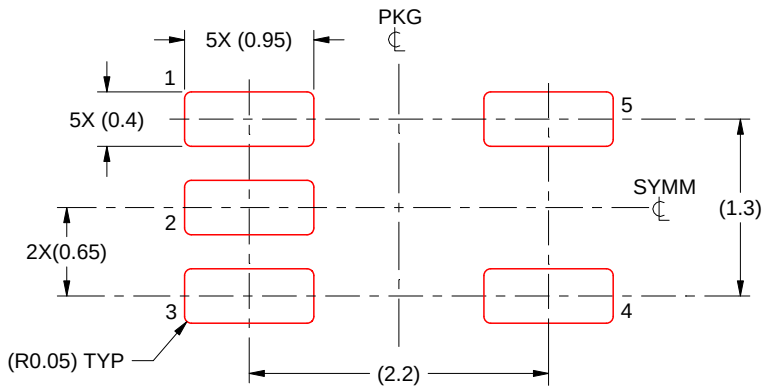


SOLDER MASK DETAILS

4214834/G 11/2024

NOTES: (continued)

7. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
8. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

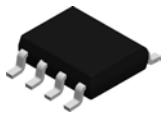


SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 THICK STENCIL
SCALE:18X

4214834/G 11/2024

NOTES: (continued)

9. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
10. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

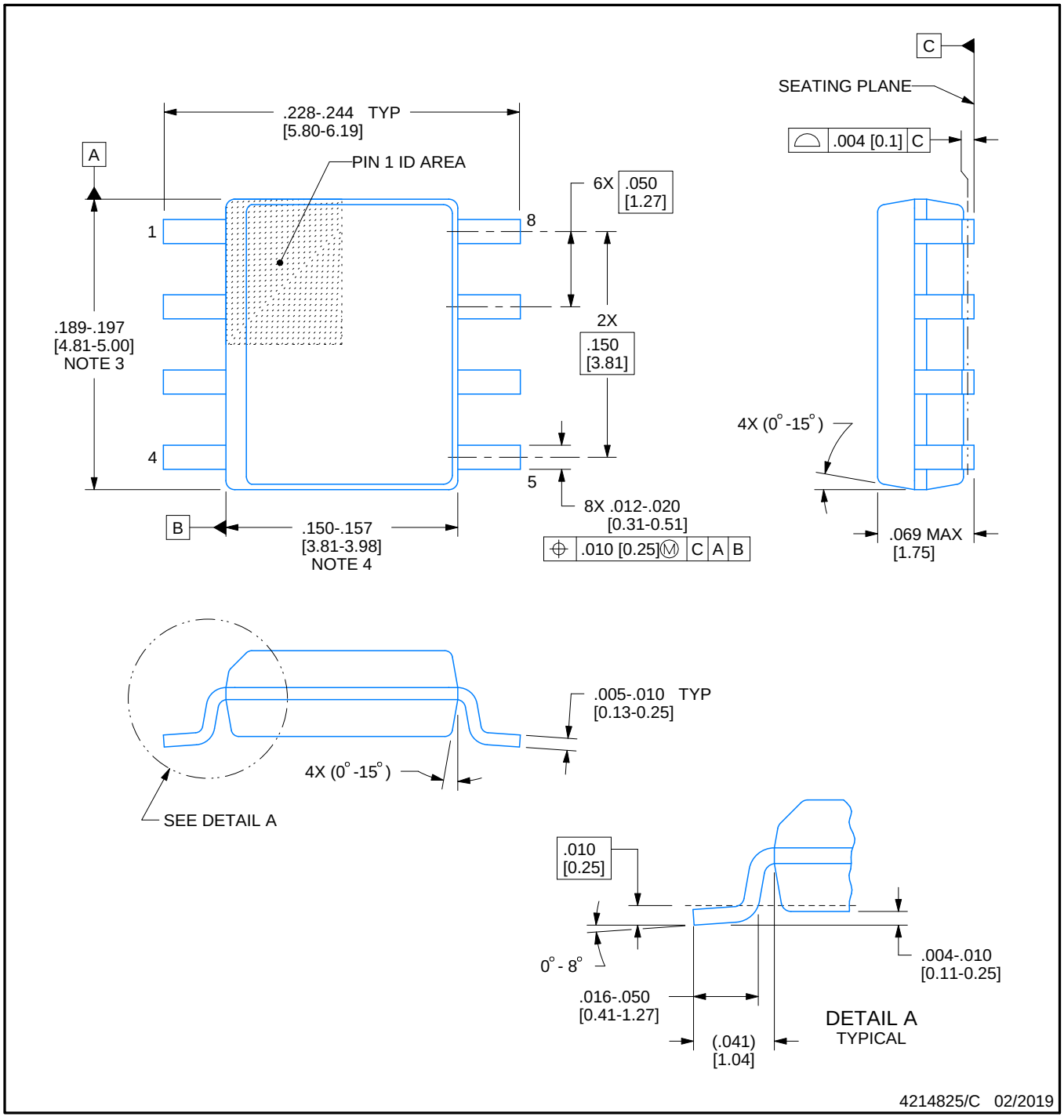


PACKAGE OUTLINE

D0008A

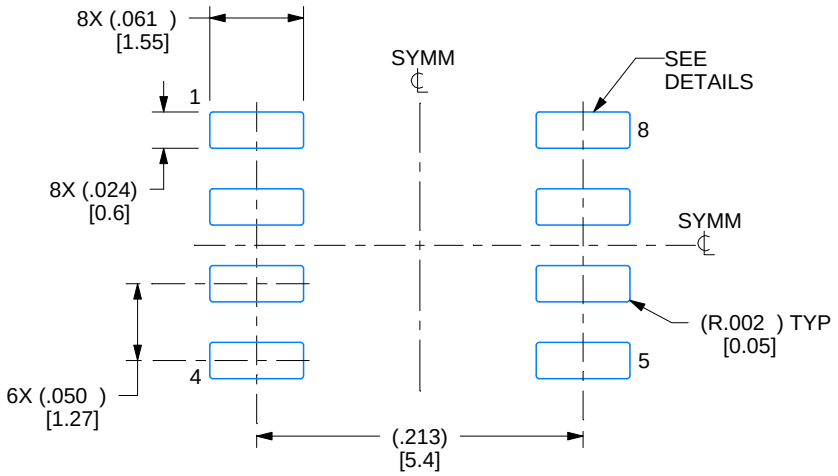
SOIC - 1.75 mm max height

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT

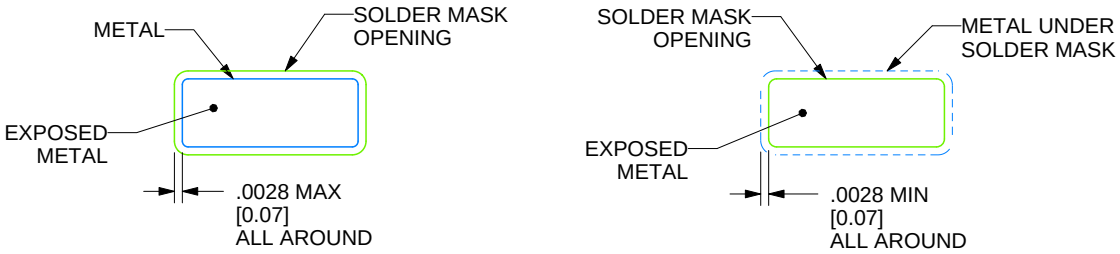


NOTES:

1. Linear dimensions are in inches [millimeters]. Dimensions in parenthesis are for reference only. Controlling dimensions are in inches. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed .006 [0.15] per side.
4. This dimension does not include interlead flash.
5. Reference JEDEC registration MS-012, variation AA.



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:8X



SOLDER MASK DETAILS

4214825/C 02/2019

NOTES: (continued)

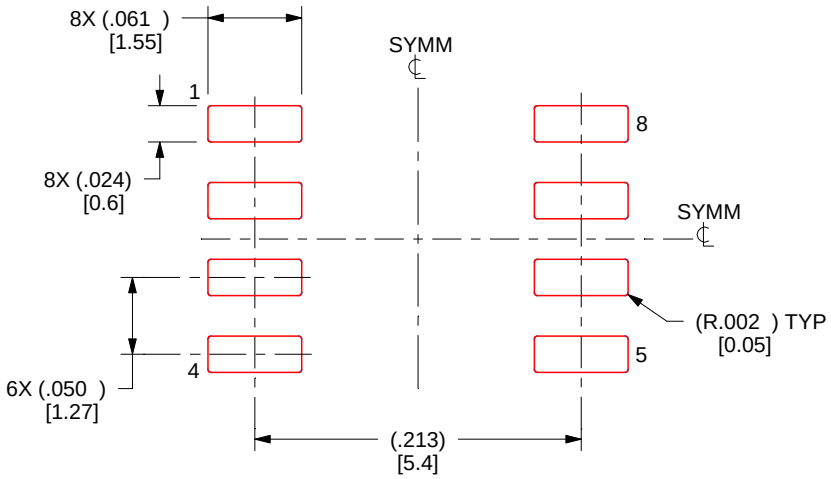
6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

D0008A

SOIC - 1.75 mm max height

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON .005 INCH [0.125 MM] THICK STENCIL
SCALE:8X

4214825/C 02/2019

NOTES: (continued)

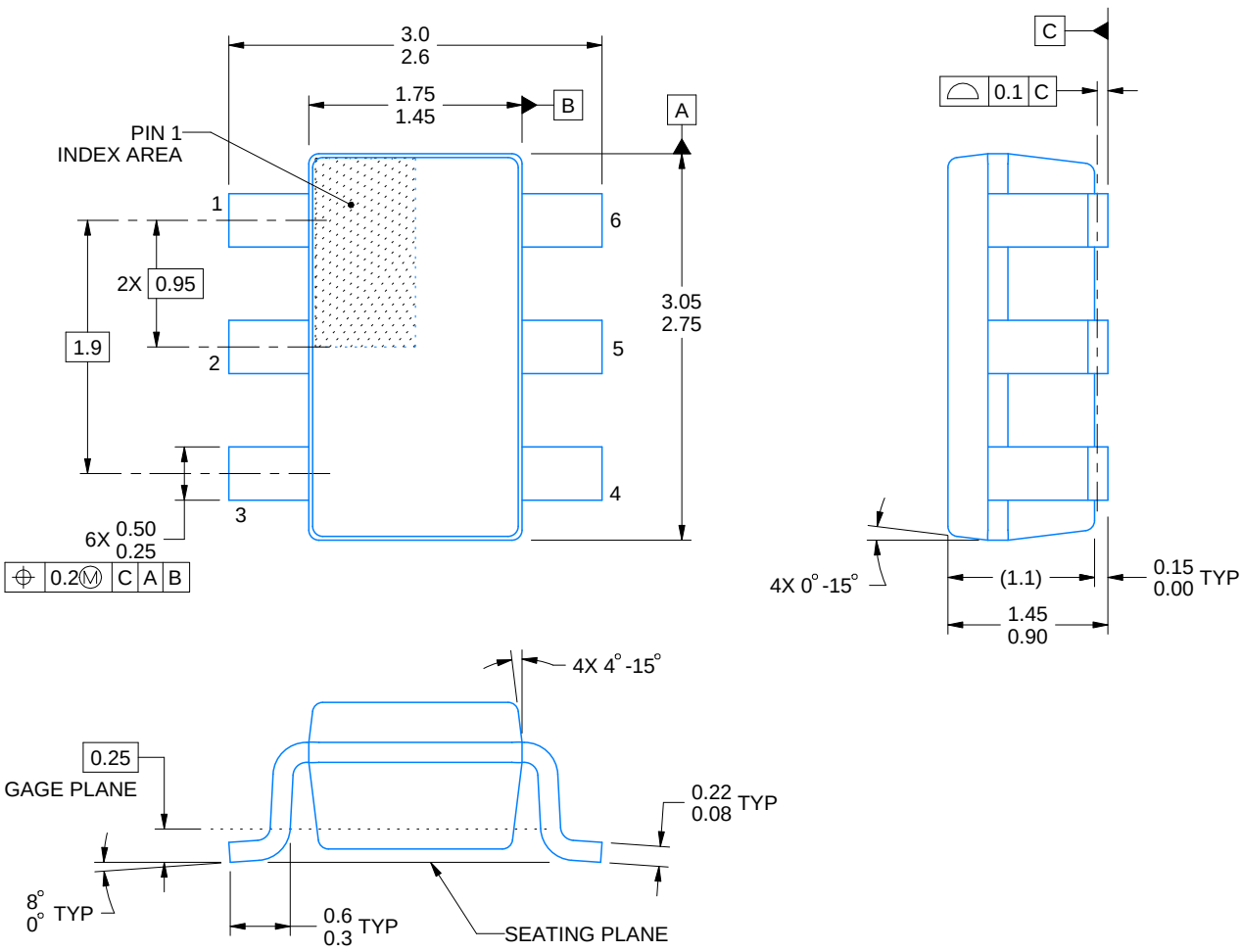
8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

PACKAGE OUTLINE

DBV0006A

SOT-23 - 1.45 mm max height

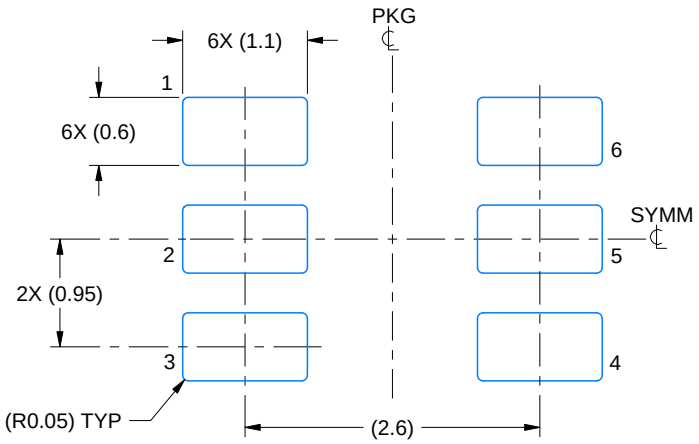
SMALL OUTLINE TRANSISTOR



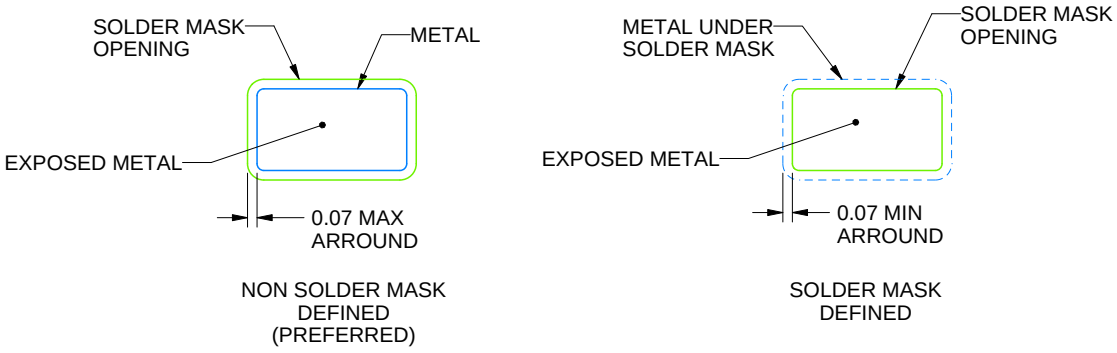
4214840/G 08/2024

NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. Body dimensions do not include mold flash or protrusion. Mold flash and protrusion shall not exceed 0.25 per side.
4. Leads 1,2,3 may be wider than leads 4,5,6 for package orientation.
5. Refernce JEDEC MO-178.



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:15X

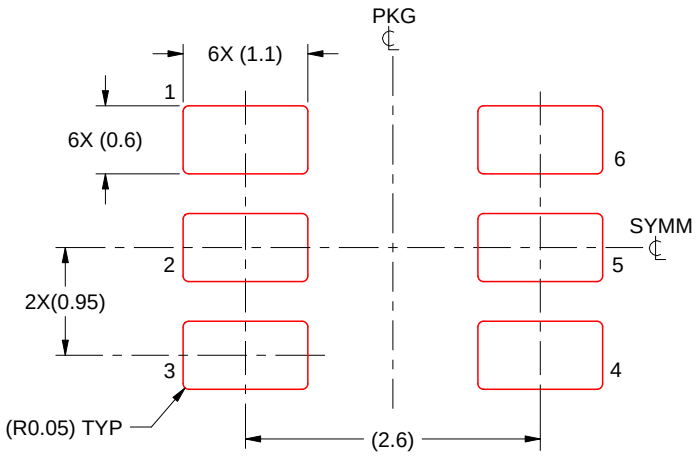


SOLDER MASK DETAILS

4214840/G 08/2024

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE:15X

4214840/G 08/2024

NOTES: (continued)

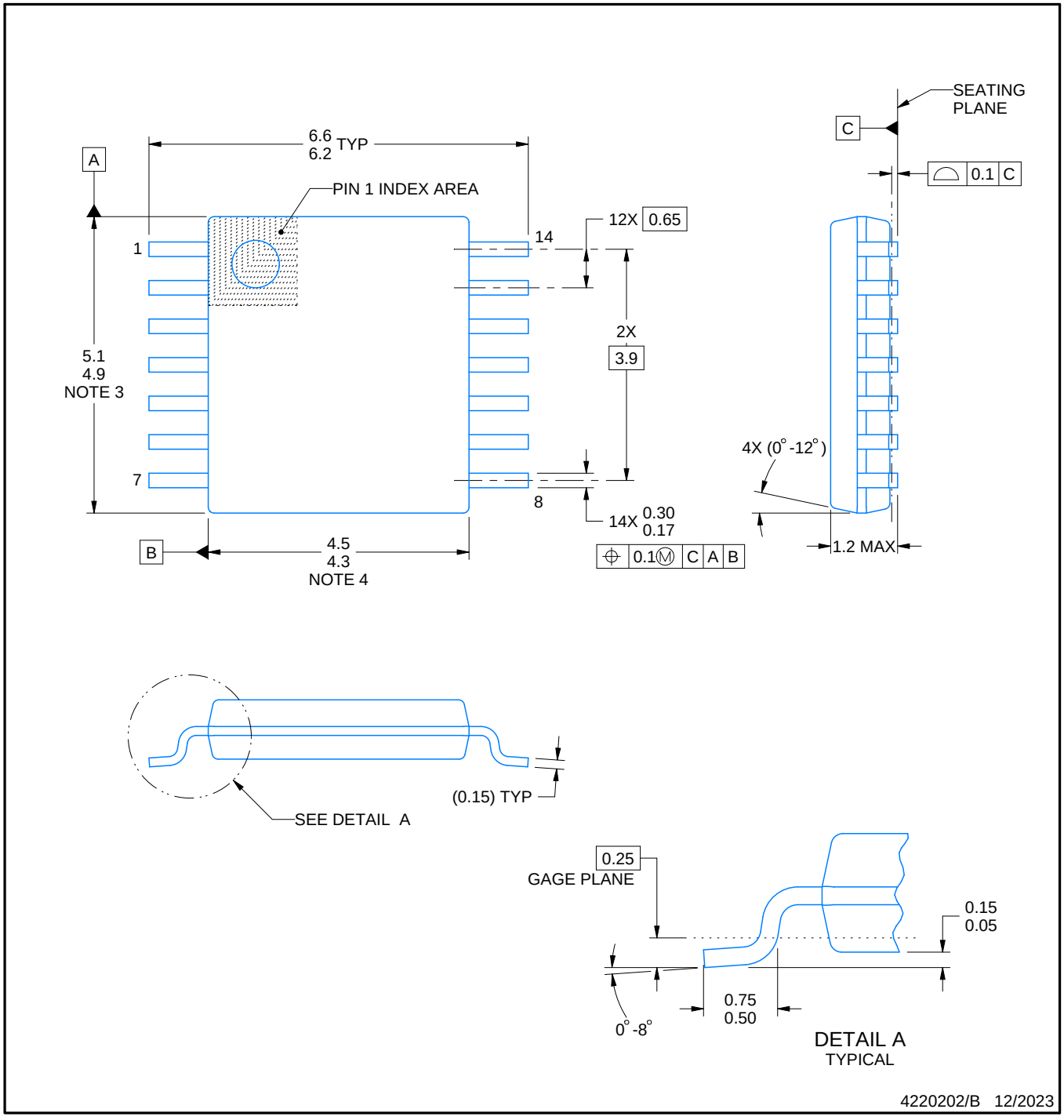
8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

PACKAGE OUTLINE

PW0014A

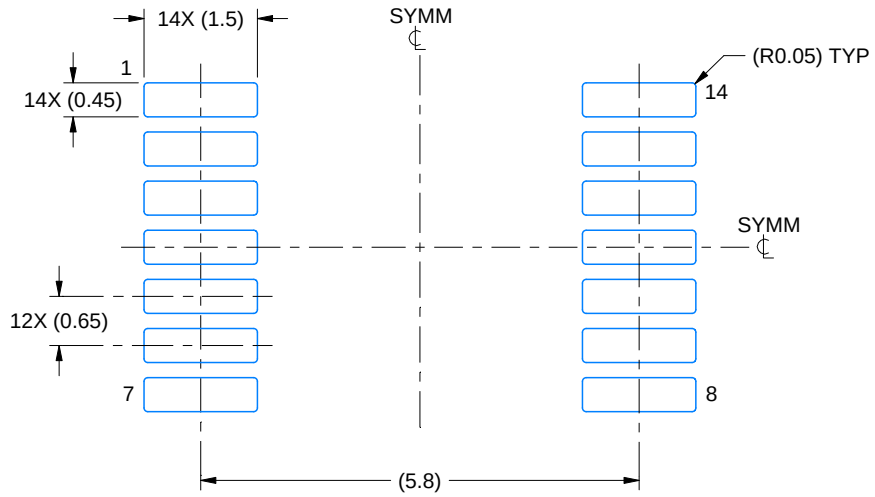
TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE

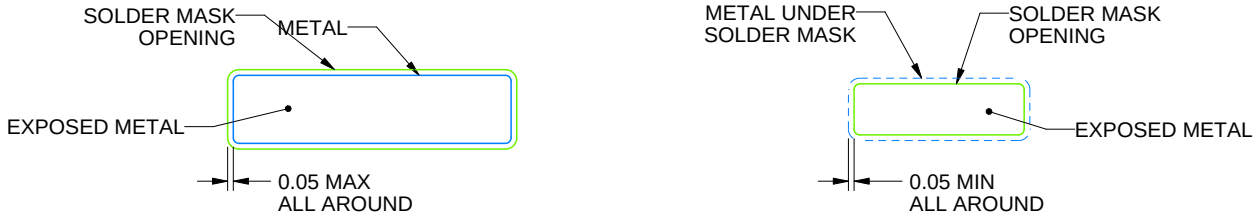


NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MO-153.



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 10X

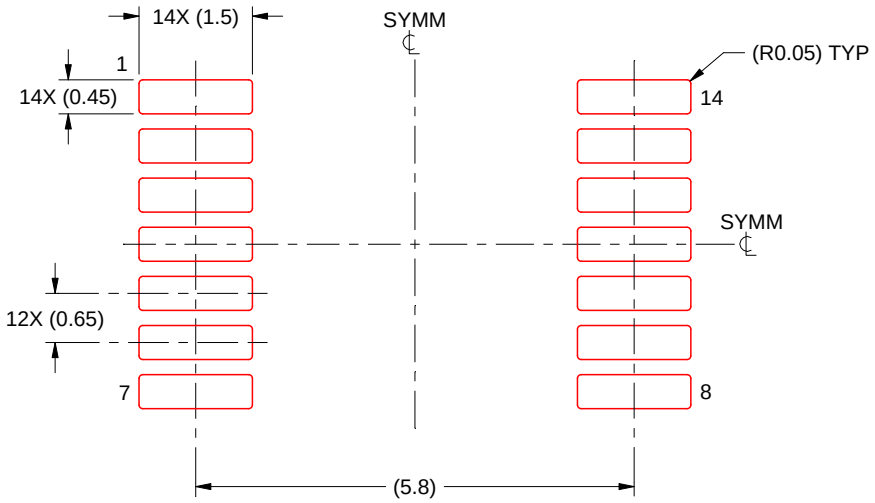


SOLDER MASK DETAILS

4220202/B 12/2023

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE: 10X

4220202/B 12/2023

NOTES: (continued)

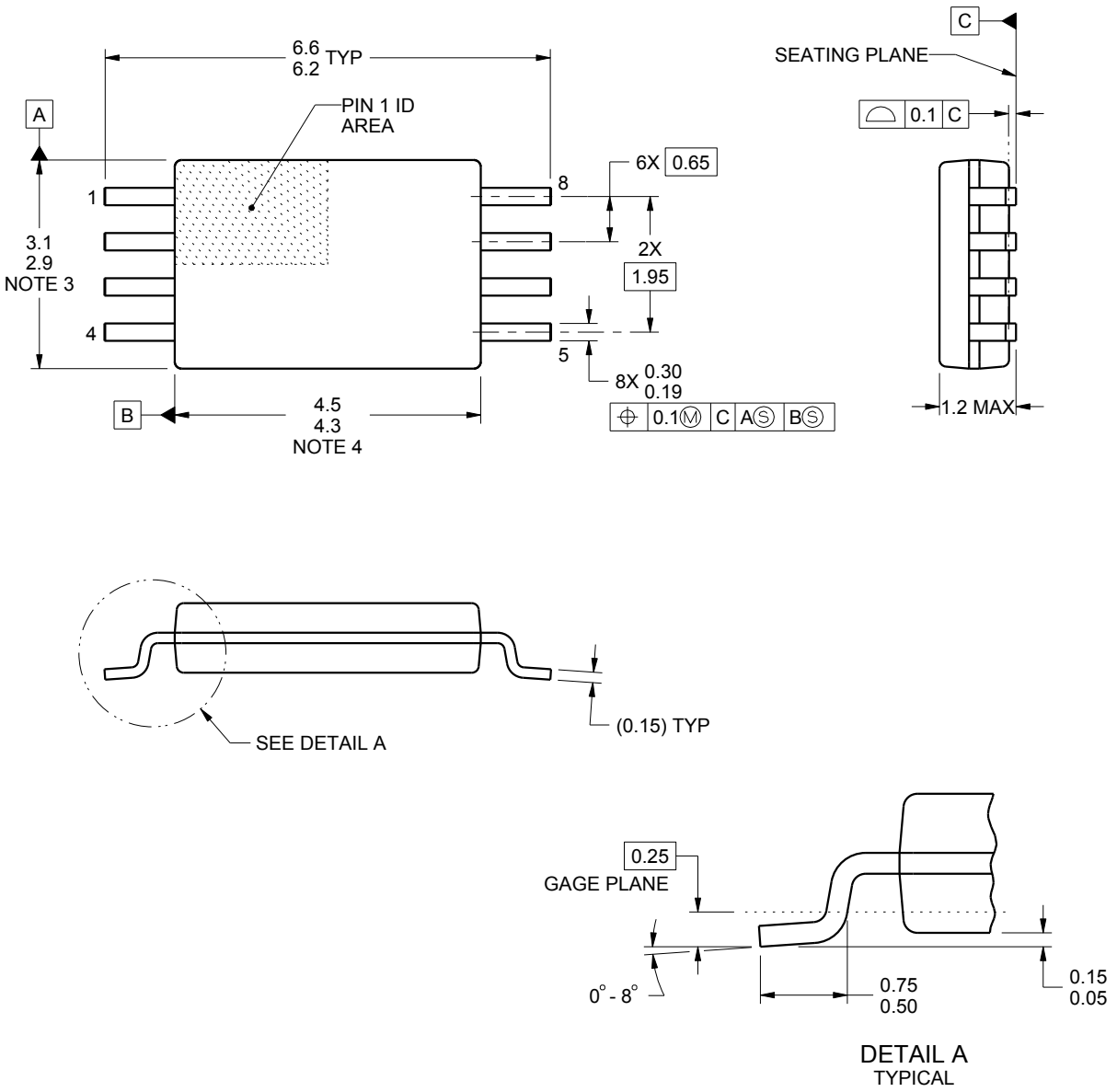
8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

PACKAGE OUTLINE

PW0008A

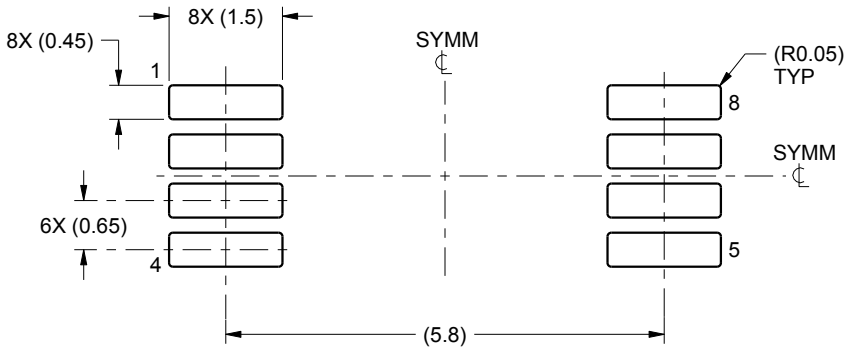
TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE

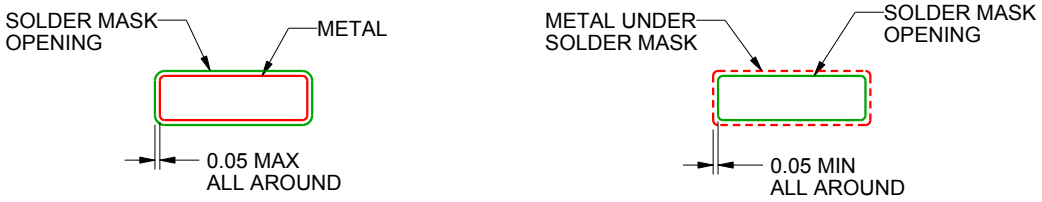


NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MO-153, variation AA.



LAND PATTERN EXAMPLE
SCALE:10X

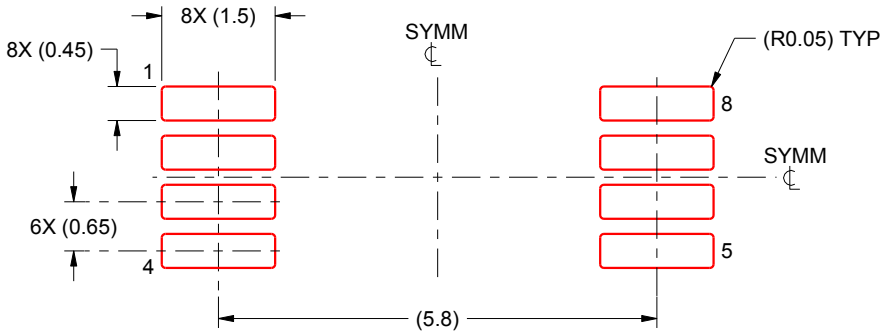


SOLDER MASK DETAILS
NOT TO SCALE

4221848/A 02/2015

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE:10X

4221848/A 02/2015

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、与某特定用途的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保法规或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。对于因您对这些资源的使用而对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，您将全额赔偿，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 TI 销售条款)、TI 通用质量指南 或 ti.com 上其他适用条款或 TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。 除非德州仪器 (TI) 明确将某产品指定为定制产品或客户特定产品，否则其产品均为按确定价格收入目录的标准通用器件。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

版权所有 © 2026，德州仪器 (TI) 公司

最后更新日期：2025 年 10 月